



Maria Jesús Martin Martínez

Generado desde: Editor CVN de FECYT

Fecha del documento: 21/01/2022

v 1.4.3

1ff59366bc465da2aca9beb81ed625d4

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en <http://cvn.fecyt.es/>

Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación. Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Una vez finalizados los estudios de Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca (USAL) (Premio Extraordinario, 1992) **María Jesús Martín** comenzó su carrera investigadora como becaria FPI estudiando dispositivos de Si y SiGe mediante el desarrollo de un simulador 1D Monte Carlo. Durante 1997 y 1998 disfrutó de una beca del “Programa Nacional de Formación de Doctores y Tecnólogos” en la Universidad Tecnológica de Delft, Países Bajos. Trabajó como IP de TUDelft en el Proyecto Europeo SIGMA (Si-licon Ge-rmanium for Mobile Applications), relacionado con el diseño y la fabricación (con tecnología de TEMIC Semiconductors) de un sistema de telefonía móvil de tercera generación. Simultáneamente desarrolló el simulador 2D Monte Carlo de Si e impulsó una nueva línea de investigación de dispositivos MOSFET y SOI MOSFET. En 2002 obtuvo una plaza de Profesor Titular de Universidad en la USAL. Ha impartido 12 asignaturas de diferentes titulaciones asignadas al área de Electrónica y supervisado un gran número de PFC y PFG. Ha generado material docente mediante la iniciativa Open Course Ware para varias asignaturas. Desde 2001 ha coordinado el grupo de Silicio (perteneciente al GIR ‘Nanodispositivos Electrónicos de Alta Frecuencia’) demostrando una sólida trayectoria en el estudio microscópico de los fenómenos del escalado de transistores MOSFET nanométricos y su optimización para aplicaciones de alta frecuencia (con financiación en más de 10 convocatorias Europeas, Nacionales y Autonómicas, formando parte de diferentes acciones integradas con grupos de Francia, del Reino Unido y de varias Redes Europeas -Phantoms, Eurosoi- y la Red Española de Nanotecnología y la Red Variables). Su investigación incluye dispositivos MOSFET avanzados, destacando el Proyecto STREP europeo METAMOS (IST-016677) orientado a la investigación de MOSFETs de barrera Schottky. En 2013 se decide iniciar una línea de investigación centrada en el modelado de las características del transporte y ruido electrónico en el rango de THz en nuevos materiales bidimensionales como el grafeno, con particular interés en la respuesta de la dinámica de los portadores fuera de equilibrio.

Ha colaborado de forma continuada en 25 proyectos de investigación desde 1992, divulgando el trabajo en más de 60 revistas indexadas en el ISI Web of Science con alto índice de impacto así como en más de 80 congresos nacionales e internacionales. Tiene experiencia como IP en diferentes actividades de transferencia tecnológica del conocimiento a través de contratos Art. 11 LRU con empresas, realizando estancias, visitas y reuniones de trabajo con una amplia red internacional de colaboradores. Es revisor de numerosos artículos para revistas internacionales de su ámbito científico. Ha participado en la evaluación de acciones de I+D+i como Colaboradora de la ANEP en Áreas IEL, COM, IND y TM de la Subdirección de Proyectos de Investigación de MINECO (años 2014-18). Ha organizado cuatro congresos internacionales de reconocido prestigio (EDISON, ICNF, TNT y CDE) y forma parte del Comité Científico del Simposium (SBMicro, Brasil) desde 2012. Impulsora de diferentes iniciativas de divulgación científica y comisaria de dos Exposiciones Científicas: “Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física” (2014) y “La gran revolución de la Electrónica” (2018). Desde Febrero de 2017 continúa con su trabajo como Catedrático de Universidad.



Indicadores generales de calidad de la producción científica

Descripción breve de los principales indicadores de calidad de la producción científica (sexenios de investigación, tesis doctorales dirigidas, citas totales, publicaciones en primer cuartil (Q1), índice h....). Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Catedrático de Universidad: Febrero de 2017.

Rama: Ingeniería y Arquitectura

Número de Sexenios de Investigación: 4

Fecha de concesión último sexenio de Investigación: Junio de 2018 (Diciembre de 2017)

Número de Sexenios de Transferencia del Conocimiento: 1

Fecha de concesión último sexenio de Investigación: Diciembre de 2020

Tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años: 1

De ResearchID:

- Total artículos en lista de publicaciones: 87
- Publicaciones totales en primer cuartil (Q1): 36
- Publicaciones con citas 56/87
- Citas totales: 482
- Citas medias por artículo: 5.05
- Promedio de citas/año durante los últimos 5 años (2014-2018): 36.80
- Índice h: 13

<https://orcid.org/0000-0001-9212-6118>

ResearcherID: G-4860-2015

Scopus Author ID: 55928530900



Maria Jesús Martin Martínez

Apellidos: **Martin Martínez**
Nombre: **María Jesús**
ORCID: **0000-0001-9212-6118**
ResearcherID: **G-4860-2015**
Sexo: **Mujer**
Correo electrónico: **mjmm@usal.es**
Página web personal: **http://diarium.usal.es/mjmm/**

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Universidad de Salamanca
Departamento: Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca
Categoría profesional: Catedrático de Universidad **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 28/02/2017
Modalidad de contrato: Funcionario/a **Régimen de dedicación:** Tiempo completo
Funciones desempeñadas: Catedrático de Universidad

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

| | Entidad empleadora | Categoría profesional | Fecha de inicio |
|---|---|---|-----------------|
| 1 | Universidad de Salamanca | Catedrático de Universidad | 28/02/2017 |
| 2 | Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca | Profesor Titular de Universidad | 25/02/2002 |
| 3 | Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca | Profesor Asociado | 01/01/2000 |
| 4 | Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca | Ayudante Facultad. Doctor | 01/01/1997 |
| 5 | Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca | Ayudante Facultad | 01/01/1995 |
| 6 | Dpto. Física Aplicada Universidad de Salamanca | Becario de Investigación. Programa de Formación de Personal Investigador en España de la Universidad de Salamanca Area: Electrónica | 01/01/1993 |
| 7 | Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca | Contrato de Colaboración Docente | 01/10/1992 |

1 Entidad empleadora: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Categoría profesional: Catedrático de Universidad
Fecha de inicio: 28/02/2017



- 2** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca
Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 25/02/2002
- 3** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca
Categoría profesional: Profesor Asociado **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 01/01/2000 **Duración:** 2 años - 1 mes - 23 días
- 4** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca
Categoría profesional: Ayudante Facultad. Doctor **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 01/01/1997 **Duración:** 3 años
- 5** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca
Categoría profesional: Ayudante Facultad **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 01/01/1995 **Duración:** 2 años
- 6** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada Universidad de Salamanca
Categoría profesional: Becario de Investigación. Programa de Formación de Personal Investigador en España de la Universidad de Salamanca Area: Electrónica
Fecha de inicio: 01/01/1993 **Duración:** 3 años
- 7** **Entidad empleadora:** Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias. Universidad De Salamanca
Categoría profesional: Contrato de Colaboración Docente **Gestión docente (Sí/No):** No
Fecha de inicio: 01/10/1992 **Duración:** 3 meses



Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

Nombre del título: Licenciado en Ciencias Físicas

Entidad de titulación: Universidad de Salamanca

Título homologado: No

Doctorados

Programa de doctorado: Doctor en Ciencias Físicas

Entidad de titulación: Universidad de Salamanca

Fecha de titulación: 01/11/1996

Doctorado Europeo: No

Título de la tesis: Análisis del Transporte de Carga y de los Fenómenos de Ruido Electrónico en Estructuras Si/Si_{1-x}Ge_x Bipolares

Director/a de tesis: Jesús Enrique Velázquez Pérez

Mención de calidad: No

Premio extraordinario doctor: No

Título homologado: No

Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaje y actualización (distinta a la formación académica reglada y a la sanitaria)

- Título de la formación:** Certificado de Aptitud Pedagógica. Curso 1999-2000.
Entidad de titulación: Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid. **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 30/06/2000 **Duración en horas:** 150 horas
- Título de la formación:** Realización de prácticas docentes (1 mes)
Entidad de titulación: I. E. S. Claudio Moyano de Zamora
Fecha de finalización: 30/04/2000 **Duración en horas:** 20 horas



Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento, innovación y mejora docente, nuevas tecnologías, etc., cuyo objetivo sea la mejora de la docencia

- 1 Título del curso/seminario:** Curso avanzado de cuestionarios en Studium (evaluación)
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 28/11/2020 - 08/01/2021
- 2 Título del curso/seminario:** Herramientas de Evaluación en Studium (online)
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 08/06/2020 - 08/06/2020
- 3 Título del curso/seminario:** Elaboración de "píldoras audiovisuales" para la docencia reglada y virtual
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 8 horas
Fecha de inicio-fin: 04/06/2019 - 05/06/2019
- 4 Título del curso/seminario:** Gamificación práctica: creando contextos de aprendizaje gamificados
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 8 horas
Fecha de inicio-fin: 30/05/2019 - 31/05/2019
- 5 Título del curso/seminario:** Producción Digital de MOOC
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 25/06/2018 - 25/06/2018
- 6 Título del curso/seminario:** Nueva Herramienta de Studium para Videoconferencia y Videotutoría
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 2 horas
Fecha de inicio-fin: 13/06/2018 - 13/06/2018
- 7 Título del curso/seminario:** Realización de aplicaciones sencillas para Android con APP inventor 2.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 07/07/2016 - 07/07/2016
- 8 Título del curso/seminario:** Campus virtual STUDIUM 2 (Nueva versión).
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 02/09/2015 - 03/09/2015
- 9 Título del curso/seminario:** Eventum: gestión de web en eventos académicos.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca
Duración en horas: 3 horas
Fecha de inicio-fin: 28/05/2015 - 28/05/2015



- 10 Título del curso/seminario:** Creación y gestión de espacios personales de docencia/aprendizaje con herramientas digitales.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 8 horas
Fecha de inicio-fin: 17/06/2014 - 18/06/2014
- 11 Título del curso/seminario:** Uso práctico de dispositivos móviles (DMs) en docencia.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 16/06/2014 - 16/06/2014
- 12 Título del curso/seminario:** Recursos de información para la investigación y la docencia.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2013 - 01/06/2013
- 13 Título del curso/seminario:** Investigación en acceso abierto.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/04/2013 - 01/04/2013
- 14 Título del curso/seminario:** Como usar las redes sociales en el Aula 3.0.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 20 horas
Fecha de inicio-fin: 01/07/2012 - 04/07/2012
- 15 Título del curso/seminario:** Taller de creación de webs personales Diarium.
Entidad organizadora: Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 01/07/2012 - 03/07/2012
- 16 Título del curso/seminario:** Técnicas de motivación de los estudiantes.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 8 horas
Fecha de inicio-fin: 01/07/2011 - 02/07/2011
- 17 Título del curso/seminario:** El trabajo en grupo de los alumnos. Cómo planificarlo y evaluarlo.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2011 - 01/06/2011
- 18 Título del curso/seminario:** La tutoría entre compañeros (alumnos) en la Universidad. Proceso y estrategia de implementación en un centro.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2011 - 01/06/2011
- 19 Título del curso/seminario:** Taller Avanzado de Studium: Libro de calificaciones.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 3 horas
Fecha de inicio-fin: 01/05/2011 - 01/05/2011



- 20** **Título del curso/seminario:** Orientaciones para cumplimentar el autoanálisis de la práctica docente IV.
Entidad organizadora: Vicerectorado de planificación estratégica. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/11/2010 - 01/11/2010
- 21** **Título del curso/seminario:** Sistemas Audiovisuales de utilización en docencia e investigación universitaria: ejemplos y aplicaciones prácticas.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 14/06/2010 - 15/06/2010
- 22** **Título del curso/seminario:** Mathematica. Introducción y Aplicaciones en Docencia.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 17/05/2010 - 17/05/2010
- 23** **Título del curso/seminario:** Ejemplos de las Universidades Españolas en cuanto a las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.
Entidad organizadora: Fundación General de la Universidad de Salamanca y Obra Social Caja Madrid.
Duración en horas: 15 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2009 - 04/06/2009
- 24** **Título del curso/seminario:** La energía solar: térmica y fotovoltaica.
Entidad organizadora: Fundación General de la Universidad de Salamanca y Obra Social Caja Madrid.
Duración en horas: 2 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2009 - 01/06/2009
- 25** **Título del curso/seminario:** Seminario I, plan de ambientalización curricular.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/06/2009 - 01/06/2009
- 26** **Título del curso/seminario:** II Congreso Internacional "Innovamos Juntos". Profesión y Docencia ante una escuela que se transforma.
Entidad organizadora: Central Sindical Independiente y de Funcionarios
Duración en horas: 30 horas
Fecha de inicio-fin: 07/05/2009 - 07/05/2009
- 27** **Título del curso/seminario:** Taller de autoanálisis de la práctica docente.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/05/2009 - 01/05/2009
- 28** **Título del curso/seminario:** Curso de Adaptación al EEES: Uso de la pizarra digital en el ámbito universitario.
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 01/07/2008 - 02/07/2008



- 29** **Título del curso/seminario:** Elaboración de las Guías docentes: Ciencias.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 12 horas
Fecha de inicio-fin: 01/03/2008 - 01/03/2008
- 30** **Título del curso/seminario:** Elaboración de las Guías docentes: diseño por competencias y distribución del crédito europeo.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 4 horas
Fecha de inicio-fin: 01/03/2008 - 01/03/2008
- 31** **Título del curso/seminario:** Guía en 5 pasos para adaptar una asignatura al EEES apoyándose en EUDORED.
Entidad organizadora: Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 10 horas
Fecha de inicio-fin: 01/03/2008 - 02/02/2008
- 32** **Título del curso/seminario:** Introducción al LATEX.
Entidad organizadora: Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 30 horas
Fecha de inicio-fin: 01/07/2007 - 04/07/2007
- 33** **Título del curso/seminario:** Creación de páginas web con Dreamweaver.
Entidad organizadora: Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua. Universidad de Salamanca.
Duración en horas: 14 horas
Fecha de inicio-fin: 01/11/2006 - 03/11/2006

Conocimiento de idiomas

| Idioma | Comprensión auditiva | Comprensión de lectura | Interacción oral | Expresión oral | Expresión escrita |
|---------|----------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Francés | A2 | B1 | A2 | A1 | A1 |
| Inglés | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |

Actividad docente

Formación académica impartida

- 1** **Nombre de la asignatura/curso:** Electrónica de Comunicaciones (4º Curso)
Titulación universitaria: Grado en Física. Plan de Estudios de 2008.
Fecha de inicio: 01/10/2012 **Fecha de finalización:** 30/09/2022
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 2** **Nombre de la asignatura/curso:** Fundamentos Físicos (Primer curso)
Titulación universitaria: Grado en Ingeniería Informática (GII). Plan de Estudios de 2010
Fecha de inicio: 01/10/2010 **Fecha de finalización:** 30/09/2022
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca



- 3 Nombre de la asignatura/curso:** Laboratorio de Electrónica (4º Curso)
Titulación universitaria: Grado en Física. Plan de Estudios de 2008.
Fecha de inicio: 01/10/2012 **Fecha de finalización:** 30/09/2021
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 4 Nombre de la asignatura/curso:** Sistemas Electrónicos de Comunicaciones (5º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/2007 **Fecha de finalización:** 30/09/2012
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 5 Nombre de la asignatura/curso:** Microelectrónica (Primer curso)
Titulación universitaria: Ingeniería en Informática (Ciclo superior). Plan de Estudios de 1999.
Fecha de inicio: 01/10/2008 **Fecha de finalización:** 30/09/2011
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 6 Nombre de la asignatura/curso:** Electronica (Primer curso)
Titulación universitaria: Ingeniería Técnica Informática de Sistemas (ITIS). Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/2007 **Fecha de finalización:** 30/09/2010
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 7 Nombre de la asignatura/curso:** Unidades Funcionales del Computador (ITIG)
Titulación universitaria: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG). Plan de Estudios de 2003.
Fecha de inicio: 01/10/2004 **Fecha de finalización:** 30/09/2008
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
- 8 Nombre de la asignatura/curso:** Comportamiento Electrónico de Materiales (1er Curso)
Titulación universitaria: Ingeniería de Materiales (Ciclo superior). Plan de Estudios de 1999.
Fecha de inicio: 01/10/2002 **Fecha de finalización:** 30/09/2008
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
- 9 Nombre de la asignatura/curso:** Instrumentación (1er Curso)
Titulación universitaria: Ingeniería de Materiales (Ciclo superior). Plan de Estudios de 1999.
Fecha de inicio: 01/10/2002 **Fecha de finalización:** 30/09/2007
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
- 10 Nombre de la asignatura/curso:** Materiales Electrónicos (2º Curso)
Titulación universitaria: Ingeniería de Materiales (Ciclo superior). Plan de Estudios de 1999.
Fecha de inicio: 01/10/2001 **Fecha de finalización:** 30/09/2007
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
- 11 Nombre de la asignatura/curso:** Electronica (Primer curso)
Titulación universitaria: Ingeniería Técnica Informática de Sistemas (ITIS). Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/1997 **Fecha de finalización:** 30/09/2003
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 12 Nombre de la asignatura/curso:** Electrónica (4º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/1997 **Fecha de finalización:** 30/09/2001
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca



- 13 Nombre de la asignatura/curso:** Dispositivos Electrónicos de Alta Frecuencia (4º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/1996 **Fecha de finalización:** 30/09/2001
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 14 Nombre de la asignatura/curso:** Tecnología Electrónica (4º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1997.
Fecha de inicio: 01/10/1998 **Fecha de finalización:** 30/09/2000
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 15 Nombre de la asignatura/curso:** Electronica (Primer curso)
Titulación universitaria: Ingeniería Técnica Informática (ITI). Plan de Estudios de 1992.
Fecha de inicio: 01/10/1994 **Fecha de finalización:** 30/09/1997
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 16 Nombre de la asignatura/curso:** Electrónica II (5º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1973.
Fecha de inicio: 01/10/1994 **Fecha de finalización:** 30/09/1997
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 17 Nombre de la asignatura/curso:** Electrónica I (4º Curso)
Titulación universitaria: Licenciatura en Física. Plan de Estudios de 1973.
Fecha de inicio: 01/10/1994 **Fecha de finalización:** 30/09/1996
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 18 Nombre de la asignatura/curso:** Electronica y sistemas digitales, I (Primer curso)
Titulación universitaria: Diplomatura en Informática. Plan de Estudios de 1989.
Fecha de inicio: 01/10/1992 **Fecha de finalización:** 31/12/1992
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

- 1 Título del trabajo:** Transporte de portadores fuera de equilibrio en grafeno y dispositivos basados en grafeno
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Jose Manuel Iglesias
Fecha de defensa: 10/06/2019
- 2 Título del trabajo:** Exposición virtual de la Colección de Aparatos de Física de la Facultad de Ciencias
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Martin M. J.; Perez M. B.; Gil A. B.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Diego Lopez Santos
Calificación obtenida: Sobresaliente
Fecha de defensa: 15/09/2016
- 3 Título del trabajo:** Cerradura Digital con Arduino
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Gil A. B.; Martin M. J.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad



Alumno/a: M^a Victoria Cardaba Ramos
Calificación obtenida: Aprobado
Fecha de defensa: 06/10/2015

- 4 Título del trabajo:** Estudio de la variabilidad en el alineamiento de las puertas en transistores DG-SB-MOSFET: influencia sobre sus características estáticas y aspectos microscópicos del transporte
Tipo de proyecto: Tesina
Codirector/a tesis: Rengel R.; María Jesús Martín Martínez
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora
Tipo de entidad: Centros y Estructuras Universitarias y Asimilados
Alumno/a: José Manuel Iglesias Pérez
Calificación obtenida: Sobresaliente Cum Laude
Fecha de defensa: 24/09/2014
- 5 Título del trabajo:** Estudio de la Variabilidad en el alineamiento de las puertas en transistores DG-MOSFET de barrera Schottky
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Martín M. J.; Rengel, R.
Entidad de realización: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Calificación obtenida: Sobresaliente
Fecha de defensa: 11/03/2014
- 6 Título del trabajo:** Escalado de dispositivos Graded-Channel SOI MOSFET mediante el método de Monte Carlo
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Martin M. J.; Rengel R
Entidad de realización: Universidad de Salamanca
Tipo de entidad: Universidad
Alumno/a: Javier Sanchez Ruiperez
Calificación obtenida: Sobresaliente
Fecha de defensa: 24/07/2013
- 7 Título del trabajo:** Estudio Monte Carlo de transistores SB- MOSFET de doble puerta: Influencia del espesor de la capa activa de Silicio en las características estáticas
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Martin M. J.; Rengel, R.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca
Alumno/a: José Santiago García Iglesias
Calificación obtenida: Matrícula de Honor
Fecha de defensa: 04/03/2013
- 8 Título del trabajo:** Efecto del uso de capas de segregación de dopantes en las características estáticas de los transistores SBMOSFET
Tipo de proyecto: Proyecto Final de Carrera
Codirector/a tesis: Rengel R.; Martin M. J:
Entidad de realización: Escuela Politécnica Superior de Zamora
Tipo de entidad: Centros y Estructuras Universitarias y Asimilados
Alumno/a: Carlos Couso Fontanillo
Calificación obtenida: Matrícula de Honor
Fecha de defensa: 22/10/2011



- 9** **Título del trabajo:** Modelado de estructuras Schottky y de transistores MOSFET con contactos de fuente y drenador metálicos para aplicaciones de alta frecuencia
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Codirector/a tesis: Martin M. J.; Rengel, R.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca
Alumno/a: Elena Pascual Corral
Calificación obtenida: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de defensa: 11/06/2010
- 10** **Título del trabajo:** Simulación Monte Carlo de fenómenos de transporte túnel y termoiónico en diodos de barrera Schottky
Tipo de proyecto: Tesina
Codirector/a tesis: Rengel R.; Martin M. J.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Elena Pascual
Calificación obtenida: Sobresaliente Cum Laude
Fecha de defensa: 01/12/2006
- 11** **Título del trabajo:** Analisis de los fenomenos de transporte y ruido electronico en transistores MOSFET y SOI submicrometricos
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Codirector/a tesis: Martin M. J.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Raul Rengel
Calificación obtenida: Sobresaliente "Cum Laude"
Fecha de defensa: 03/02/2003
- 12** **Título del trabajo:** Estudio del transporte de carga y del ruido electrónico en Si/SiGe y SiGe/Si 001. Influencia de los efectos de alto dopaje
Tipo de proyecto: Tesina
Codirector/a tesis: Martin M. J.
Entidad de realización: Universidad de Salamanca
Alumno/a: Rengel R.
Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude
Fecha de defensa: 25/06/1999

Publicaciones docentes o de carácter pedagógico, libros, artículos, etc.

- 1** Martín, M. J.. Ingeniería de materiales (2º ciclo, 2º curso). 2002/03-2007/08., OpenCourseWare de la Universidad de Salamanca. (España): 2002. Disponible en Internet en: <<http://ocw.usal.es/enseñanzas-tecnicas/materiales-electronicos>>.
Nombre del material: Materiales Electrónicos (10921): OCW de la Universidad de Salamanca. 254 páginas.
Fecha de elaboración: 01/01/2012
Tipo de soporte: Apuntes
- 2** Mateos, J.; Martín, M. J.; Pardo, D.; González, T.. Grado en Ingeniería Informática (primer curso). 2010/2011-actualidad, OpenCourseWare de la Universidad de Salamanca. 2010. Disponible en Internet en: <<http://ocw.usal.es/enseñanzas-tecnicas/fundamentos-fisicos>>.
Nombre del material: Fundamentos Físicos (101103): OCW de la Universidad de Salamanca. 175 páginas.
Fecha de elaboración: 20/09/2009
Tipo de soporte: Apuntes



- 3** Martín, M. J.. Apuntes en Studium (Moodle de la Universidad de Salamanca). Docencia de 2009/2010-actualidad. Grado en Física (5 curso). <https://moodle.usal.es/course/view.php?id=20139>, 2009.
Nombre del material: Electrónica de Comunicaciones.
Fecha de elaboración: 01/02/2009
Tipo de soporte: Apuntes
- 4** Martin M. J.. Apuntes en Studium (Moodle de la Universidad de Salamanca). Docencia de 2008/09-2010/2011. Ingeniería Superior Informática (segundo curso). <https://moodle.usal.es/course/view.php?id=296>, 2008.
Nombre del material: Microelectrónica
Fecha de elaboración: 01/10/2008
Tipo de soporte: Apuntes
- 5** Martin M. J.; Rengel R.. Ingeniería Informática de Sistemas (primer curso).2007/08-2009/10., OpenCourseWare de la Universidad de Salamanca. 2007. Disponible en Internet en: <<http://ocw.usal.es/enseanzas-tecnicas/electronica>>.
Nombre del material: Electrónica (10921): OCW de la Universidad de Salamanca. 428 páginas.
Fecha de elaboración: 01/09/2007
Tipo de soporte: Apuntes
- 6** Martín, M. J.. Ingeniería de materiales (2º ciclo, primer curso). 2003/04-2007/08., OpenCourseWare de la Universidad de Salamanca. 2003. Disponible en Internet en: <<http://ocw.usal.es/enseanzas-tecnicas/instrumentacion>>.
Nombre del material: Instrumentación (10909): OCW de la Universidad de Salamanca. 216 páginas.
Fecha de elaboración: 01/01/2003
Tipo de soporte: Apuntes
- 7** Perez S.; B. G. Vasallo; Martín, M. J.; Rengel, R.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2013., MID. Memorias de Innovación Docente, 2013-2014.. 01/01/2013. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124791>>.
Nombre del material: Actualización de Osciloscopios del laboratorio de electrónica de la facultad de ciencias
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 8** Martín, M. J.; Vasallo B. G.; Rengel, R.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2011., MID. Memorias de Innovación Docente, 2010-2011.. 01/01/2011. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/112879>>.
Nombre del material: Adaptación de la Metodología de Enseñanza de los Fundamentos Físicos de la Informática al EEES.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 9** Rengel, R.; Vasallo B. G.; Martín, M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2015, MID. Memorias de Innovación Docente, 2013-2014.. 01/01/2014. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124657>>.
Nombre del material: Adquisición de competencias en mecatrónica mediante el aprendizaje basado en mini-proyectos.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 10** Martín, M. J.; Rengel, R.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2010, MID. Memorias de Innovación Docente, 2009 - 2010.. 01/01/2010. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/81660>>.
Nombre del material: Aplicación de nuevas metodologías a la docencia de la microelectrónica en el ámbito de las ingenierías.



Tipo de soporte: Capítulos de libros

- 11** Pascual E; Vasallo B. G.; Rengel, R.; Martín, M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2015., MID. Memorias de Innovación Docente, 2014-2015. 01/01/2015. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/126990>>.
Nombre del material: Diseño de prácticas de laboratorio para la asignatura periféricos.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 12** Rengel, R.; Martín, M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2012, MID. Memorias de Innovación Docente, 2011-2012.. 01/01/2012. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/120797>>.
Nombre del material: Diseño y ejecución de recursos docentes para la enseñanza de la Electrónica en Ingeniería Mecánica.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 13** Vasallo B. G.; Pacual E.; Rengel, R.; Martín, M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2015, MID. Memorias de Innovación Docente, 2014-2015.. 01/01/2015. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/126947>>.
Nombre del material: Diseño y fabricación de un cuadricóptero en la asignatura Electrónica de los Sistemas Mecánicos mediante el acercamiento al Aprendizaje Basado en Proyectos.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 14** Martín, M. J.; J. M. Mateos Roco; J. I. Iñiguez de la Torre; Conejero E.; Iglesias J.; Santos M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2015., MID. Memorias de Innovación Docente, 2014-2015. 01/01/2015. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/126948>>.
Nombre del material: Exposición de aparatos de medida de los laboratorios de Física.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 15** Martín, M. J.; Vasallo B. G.; Rabanillo, M. A.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2012., MID. Memorias de Innovación Docente, 2011-2012.. 01/01/2012. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/120796>>.
Nombre del material: Implementación de nuevas estrategias docentes para la mejora de la enseñanza de los Fundamentos Físicos en el contexto de los Grados en Ingeniería Informática.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 16** Rengel, R.; Martín, M. J.; Elena Pascual Corral; B. G. Vasallo. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2015, MID. Memorias de Innovación Docente, 2014-2015.. 01/01/2015. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/126974>>.
Nombre del material: Innovación docente en la enseñanza de los Fundamentos Físicos de la Informática: un enfoque aplicado. Repositorio
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 17** Martín, M. J.; B. G. Vasallo; I. Iñiguez-de-la-Torre; Rengel, R.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2014., MID. Memorias de Innovación Docente, 2013-2014.. 01/01/2014. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/124703>>.
Nombre del material: Metodología de integración de prácticas experimentales y virtuales en la enseñanza de la Electrónica en Ingenierías.
Tipo de soporte: Capítulos de libros
- 18** Martín, M. J.; Iñiguez de la Torre, J. I.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2016., MID. Memorias de Innovación Docente, 2015-2016.. 01/01/2016. Disponible en Internet en: <<http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/130714>>.
Nombre del material: Segunda Fase de la colección de aparatos de medida de los laboratorios de Física.



Tipo de soporte: Capítulos de libros

- 19** Rengel, R.; Martín, M. J.; Vasallo B. G.. IEEE Transactions On Education. 55, n 4, Nov. 2012, lee transactions on education.. (Estados Unidos de América): 01/08/2012. Disponible en Internet en: <ieeexplore.ieee.org/iel5/13/6341131/06189764.pdf>. ISSN 0018-9359
Nombre del material: Supervised Coursework as a Way of Improving Motivation in the Learning of Digital Electronics
Tipo de soporte: Artículo/s
- 20** Rengel, R.; Vasallo B. G.; Martín, M. J.. Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca. 2013., MID. Memorias de Innovación Docente, 2012-2013. 01/01/2013. Disponible en Internet en: <http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122645>.
Nombre del material: Utilización de recursos cinematográficos y diseño de materiales docentes para la enseñanza de la Electrónica
Tipo de soporte: Capítulos de libros

Participación en proyectos de innovación docente

- 1** **Título del proyecto:** Fomento del pensamiento crítico en el ámbito de la ingeniería del terreno: contraste entre realidad y teoría con la ayuda de métodos de auscultación electrónicos (2016)
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): J. Nespereira.
Nº de participantes: 6
Importe concedido: 360 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Local
Fecha de inicio-fin: 01/09/2016 - 31/08/2017
- 2** **Título del proyecto:** Realización de videotutoriales mediante tecnología de captura de pantalla como apoyo docente en asignaturas de Electrónica (2016)
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): R. Rengel
Nº de participantes: 4
Importe concedido: 400 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Local
Fecha de inicio-fin: 01/09/2016 - 31/08/2017
- 3** **Título del proyecto:** Segunda fase de colección de aparatos de medida de los laboratorios de física (ID2015/0208)
Tipo de participación: Coordinador
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): M. J. Martin
Nº de participantes: 2
Importe concedido: 165 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Local
Fecha de inicio-fin: 01/09/2015 - 31/08/2016



- 4** **Título del proyecto:** Exposición de aparatos de medida de los laboratorios de Física (ID2014/0227)
Tipo de participación: Coordinador
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): M. J. Martin
Nº de participantes: 8
Importe concedido: 315 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Local
Fecha de inicio-fin: 01/09/2014 - 31/08/2015
- 5** **Título del proyecto:** Diseño de prácticas de Laboratorio para la asignatura Periféricos (Grado en Ingeniería Informática) (ID2014/0315)
Ciudad entidad realización: España
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Elena Pascual Corral
Nº de participantes: 4
Importe concedido: 315 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 05/12/2014 - 30/06/2015
- 6** **Título del proyecto:** Diseño y fabricación de un cuadricóptero en la asignatura Electrónica de los Sistemas Mecánicos (Grado en Ingeniería Mecánica) mediante el acercamiento al Aprendizaje Basado en Proyectos (ID2014/0317)
Ciudad entidad realización: España
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): B. G. Vasallo
Nº de participantes: 4
Importe concedido: 190 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 05/12/2014 - 30/06/2015
- 7** **Título del proyecto:** Innovación docente en la enseñanza de los Fundamentos Físicos de la Informática: un enfoque aplicado (ID2014/0316)
Ciudad entidad realización: España
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Rengel, R.
Nº de participantes: 4
Importe concedido: 100 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 05/12/2014 - 30/06/2015
- 8** **Título del proyecto:** Actualización de osciloscopios del laboratorio de electrónica de la facultad de ciencias (ID2013/0219)
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Pérez, S.
Nº de participantes: 8
Importe concedido: 500 €



Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Local
Fecha de inicio-fin: 01/09/2013 - 31/08/2014

- 9 Título del proyecto:** Adquisición de competencias en mecatrónica mediante el aprendizaje basado en mini-proyectos (ID2013/298)
Ciudad entidad realización: España
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Rengel, R.
Nº de participantes: 3
Importe concedido: 250 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 06/02/2014 - 30/06/2014
- 10 Título del proyecto:** Metodología de integración de prácticas experimentales y virtuales en la enseñanza de la electrónica en ingenierías (ID2013/281)
Tipo de participación: Coordinador
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Martín, M. J.
Nº de participantes: 4
Importe concedido: 150 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 01/07/2013 - 30/06/2014
- 11 Título del proyecto:** Utilización de recursos cinematográficos y diseño de materiales docentes para la enseñanza de la Electrónica (ID2012/113)
Ciudad entidad realización: España
Tipo de participación: Miembro de equipo
Nombre del investigador/a principal (IP): Rengel, R.
Nº de participantes: 3
Importe concedido: 100 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 01/09/2012 - 30/06/2013
- 12 Título del proyecto:** Uso de FPGAs y medios audiovisuales en la docencia de la electrónica digital (ID11/129)
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): B. G. Vasallo
Nº de participantes: 3
Importe concedido: 650 €
Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 01/09/2011 - 31/08/2012
- 13 Título del proyecto:** Diseño y ejecución de recursos docentes para la enseñanza de la Electrónica en Ingeniería Mecánica (ID11/128)
Tipo de participación: Miembro de equipo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Rengel, R.
Nº de participantes: 2
Importe concedido: 350 €



Tipo de convocatoria: Competitivo
Fecha de inicio-fin: 01/06/2011 - 30/06/2012

14 Título del proyecto: Implementación de nuevas estrategias docentes para la mejora de la enseñanza de los Fundamentos Físicos en el contexto de los Grados en Ingeniería Informática (ID11/127)

Ciudad entidad realización: España
Nombre del investigador/a principal (IP): Martín, M. J.
Nº de participantes: 3
Tipo de convocatoria: Proyectos de Innovación Docente
Ámbito geográfico: Otros
Fecha de inicio-fin: 01/06/2011 - 31/05/2012

15 Título del proyecto: Adaptación de la metodología de enseñanza de los fundamentos físicos de la informática al EEES (ID10/118)

Ciudad entidad realización: España
Nombre del investigador/a principal (IP): Martín, M. J.
Nº de participantes: 3
Importe concedido: 450 €
Tipo de convocatoria: Proyectos de Innovación Docente
Fecha de inicio-fin: 01/06/2010 - 31/05/2011

16 Título del proyecto: Aplicación de nuevas metodologías a la docencia de la microelectrónica en el ámbito de las Ingenierías (ID09/42)

Tipo de participación: Coordinador
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nombre del investigador/a principal (IP): Martín, M. J.
Nº de participantes: 2
Tipo de convocatoria: Competitivo
Ámbito geográfico: Otros
Fecha de inicio-fin: 01/06/2009 - 31/05/2010

17 Título del proyecto: Proyecto de Innovación docente de la facultad de Ciencias: Adaptación al EEES. 2009.

Tipo de participación: Otros
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nº de participantes: 1
Fecha de inicio-fin: 01/02/2009 - 31/05/2009

18 Título del proyecto: Proyecto de Innovación docente de la facultad de Ciencias: Adaptación al EEES. 2009.

Tipo de participación: Miembro de equipo
Fecha de inicio: 01/02/2009 **Duración:** 4 meses

Participación en congresos con ponencias orientadas a la formación docente

1 Nombre del evento: III CONGRESO NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA EN RED

Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 13/07/2017
Entidad organizadora: Universitat Politècnica de València **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad organizadora: Valencia,



Recursos audiovisuales en la enseñanza universitaria de la Electrónica: una experiencia aplicada al ámbito de las Ingenierías.

- 2** **Nombre del evento:** Moderador de las 2ª Jornada de Innovación Educativa de la EPSZ. Actas del Congreso. ISBN: 978-84-7800-369-3 (Junio 2007.)
Tipo de participación: Organizativo - Otros
Entidad organizadora: Escuela politécnica superior de Zamora **Tipo de entidad:** Universidad Zamora
- 3** **Nombre del evento:** Moderador de las 1ª Jornada de Innovación Educativa de la EPSZ. Actas del Congreso. I.S.B.N. 84-686-9304-2 (Junio 2006.)
Tipo de participación: Organizativo - Otros
Entidad organizadora: Escuela politécnica superior de Zamora **Tipo de entidad:** Universidad Zamora
- 4** **Nombre del evento:** II Jornadas de Innovación Educativa. Universidad de Salamanca
Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 31/05/2013
Estrategias docentes para la evaluación de contenidos prácticos en Fundamentos Físicos de la informática.
- 5** **Nombre del evento:** II Jornadas de Innovación Educativa. Universidad de Salamanca
Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 31/05/2013
Utilización de recursos cinematográficos en la enseñanza de la Electrónica.
- 6** **Nombre del evento:** I Jornadas de Innovación Educativa. Universidad de Salamanca
Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 31/10/2011
Diseño de actividades on-line aplicadas a la docencia de la microelectrónica.
- 7** **Nombre del evento:** I Jornadas de Innovación Educativa. Universidad de Salamanca
Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 31/10/2011
Estrategias docentes para seminarios de problemas y prácticas de laboratorio en Electrónica.
- 8** **Nombre del evento:** I Jornadas de Innovación Educativa. Universidad de Salamanca
Tipo de participación: Participativo - Plenaria
Autor de correspondencia: Si
Fecha de presentación: 31/10/2011
Experiencia en la realización de trabajos tutorizados en la enseñanza de la Electrónica Digital.



Otras actividades/méritos no incluidos en la relación anterior

- 1 Descripción de la actividad:** Secretaria de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Informática (2013-actualidad)
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Fecha de finalización: 21/01/2022
- 2 Descripción de la actividad:** Curso de Formación Teórico-Práctica de Equipos de Emergencia
Entidad organizadora: Universidad de Salamanca
Fecha de finalización: 2016
- 3 Descripción de la actividad:** Realización de Prácticas de Campo: visita a la empresa Pevafersa, Toro (Zamora)
Entidad organizadora: Escuela Politécnica Superior de Zamora **Tipo de entidad:** Universidad Zamora
Fecha de finalización: 2010
- 4 Descripción de la actividad:** Miembro de la Comisión de Planes de Estudios. Escuela Politécnica Superior de Zamora (2003-2007)
Fecha de finalización: 2007
- 5 Descripción de la actividad:** Realización de Prácticas de Campo: visita al Centro Nacional de Microelectrónica (CNM-CSIC)
Entidad organizadora: Escuela Politécnica Superior de Zamora **Tipo de entidad:** Universidad Zamora
Fecha de finalización: 2003
- 6 Descripción de la actividad:** Coordinador del grupo de innovación docente en electrónica para ciencias e ingeniería: "Grupo de innovación educativa en ELEctrónica: G-Relé". Objetivo: análisis de las diferentes estrategias para la mejora docente y la motivación de los estudiantes de los Grados Ingeniería. URL: <http://grele.usal.es>
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Escuela Politécnica Superior de Zamora. Universidad de Salamanca
- 7 Descripción de la actividad:** Miembro de la Comisión de Calidad del Grado en Ingeniería Informática (2011-actualidad)
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
- 8 Descripción de la actividad:** Tutor de Prácticas de Empresa. Alumnos del Grado en Ingeniería Informática. Servicio de Inserción Profesional y Prácticas de empresa.
Entidad organizadora: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad



Aportaciones más relevantes de su CV de docencia

- 1** **Descripción:** Valoración positiva de actividad Docente
Entidad organizadora: Comisión de Evaluación de la Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 2017
- 2** **Descripción:** Valoración positiva de actividad Docente
Entidad organizadora: Comisión de Evaluación de la Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 2012
- 3** **Descripción:** Evaluación Excelente programa DOCENTIA 2006-2011
Entidad organizadora: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 2011
- 4** **Descripción:** Valoración positiva de actividad Docente
Entidad organizadora: Comisión de Evaluación de la Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 2007
- 5** **Descripción:** Valoración positiva de actividad Docente
Entidad organizadora: Comisión de Evaluación de la Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 2002
- 6** **Descripción:** Certificado de Aptitud Pedagógica
Entidad organizadora: Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad Complutense de Madrid
Fecha de finalización: 2000
- 7** **Descripción:** Valoración positiva de actividad Docente
Entidad organizadora: Comisión de Evaluación de la Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Fecha de finalización: 1997



Experiencia científica y tecnológica

Grupos/equipos de investigación, desarrollo o innovación

- 1 Nombre del grupo:** Nanodispositivos Electrónicos de Alta Frecuencia
Objeto del grupo: Modelado, simulación y caracterización eléctrica de materiales semiconductores y dispositivos nanoelectrónicos de alta frecuencia basados en tecnologías (Si, grafeno, GaAs, InP, GaN).
Entidad de afiliación: Universidad de Salamanca
Fecha de inicio: 01/09/2013
- 2 Nombre del grupo:** VARIABLES (Red Española de Variabilidad en Tecnologías, Circuitos y Sistemas Micro/Nanoelectrónicos). TEC2011-15599-E.
Objeto del grupo: Facilitar el intercambio de conocimientos y la formación de investigadores entre los diversos grupos de investigación nacionales que se encuentran desarrollando sus actividades en el ámbito de la variabilidad en electrónica.
Nombre del investigador/a principal (IP): Nafría, M.
Entidad de afiliación: Universitat Autònoma de Barcelona
Fecha de inicio: 01/07/2012 **Duración:** 1 año
- 3 Nombre del grupo:** Thematic network on Silicon on Insulator technology, devices and circuits: EUROSIOI (IST-1-506653-CA)
Objeto del grupo: European Network on Silicon on Insulator Technology, Devices and Circuits, whose main goal was to create a discussion forum for the exchange of ideas and results on the topic of Silicon-On-Insulator technologies in Europe, and to facilitate the synergy between research groups which enables the use of Silicon-On-Insulator (SOI) technology as an effective tool to push the limits of CMOS and prepare for post-CMOS.
Nombre del investigador/a principal (IP): Gámiz, F.
Entidad de afiliación: Universidad de Granada
Fecha de inicio: 01/01/2004 **Duración:** 2 años - 3 meses
- 4 Nombre del grupo:** Participante de la Red de Excelencia en Nanoelectrónica PHANTOMS financiada por la Comisión Europea (IST-2000-26021)
Objeto del grupo: The Phantoms Foundation focuses its activities on Nanoscience & Nanotechnology and is a key actor in structuring and fostering European Excellence and enhancing collaborations in this field
Fecha de inicio: 01/09/2001
- 5 Nombre del grupo:** DIMES (Delft Institute for Microsystems and Nanoelectronics). Laboratory of Electronic Components, Technology and Materials (ECTM)
Objeto del grupo: Multi-disciplinary with a strong interaction with the industry. Innovative devices and novel microstructures and materials are investigated, based on in-depth knowledge of device physics, silicon technology and electrical-material characterization.
Nombre del investigador/a principal (IP): Beenhakker, K.
Entidad de afiliación: Universidad Tecnológica de Delft
Fecha de inicio: 01/01/1997 **Duración:** 2 años - 7 meses
- 6 Nombre del grupo:** Grupo de Investigación en Dispositivos Semiconductores.
Objeto del grupo: Desarrollo y uso de técnicas de simulación Monte Carlo para estudiar materiales y dispositivos semiconductores, con especial aplicación al análisis del ruido electrónico
Nombre del investigador/a principal (IP): Pardo, D.
Entidad de afiliación: Universidad de Salamanca

Fecha de inicio: 01/09/1992

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas

- 1 Nombre del proyecto:** Dinámica Ultra-rápida de portadores y modelos multiescala para el estudio de grafeno y materiales 2D alternativos. TEC2016-80839-P

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martin M. J.

Nº de investigadores/as: 4

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad

Cód. según financiadora: TEC2016-80839-P

Fecha de inicio-fin: 01/01/2017 - 31/12/2019 **Duración:** 3 años

Cuantía total: 65.100 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo
- 2 Nombre del proyecto:** Dinámica de portadores fuera de equilibrio en grafeno y dispositivos de grafeno para electrónica de alto rendimiento (TEC2013-42622-R)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Raúl Rengel Estevez

Nº de investigadores/as: 5

Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Economía y Competitividad

Cód. según financiadora: TEC2013-42622-R

Fecha de inicio-fin: 01/01/2014 - 31/12/2016 **Duración:** 3 años

Cuantía total: 113.256 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo
- 3 Nombre del proyecto:** Modelado y optimización de arquitecturas MOSFET avanzadas para aplicaciones analógicas de alto rendimiento (SA188A11)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Autonómica

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.

Nº de investigadores/as: 2

Entidad/es financiadora/s: Junta de Castilla y León **Tipo de entidad:** P

Ciudad entidad financiadora: Valladolid, Castilla y León, España

Cód. según financiadora: SA188A11

Fecha de inicio-fin: 01/01/2011 - 31/12/2013 **Duración:** 3 años

Cuantía total: 24.000 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo



- 4** **Nombre del proyecto:** Red Española de Variabilidad en Tecnologías, Circuitos y Sistemas Micro/Nanoelectrónicos (TEC2011-15599-E)
Ciudad entidad realización: España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Monserrat Nafria Maqueda
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación **Tipo de entidad:** Publica
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Fecha de inicio-fin: 01/07/2012 - 30/06/2013
Cuantía total: 18.000 €
- 5** **Nombre del proyecto:** Investigación de transistores MOSFET nanométricos no convencionales: modelado del ruido electrónico y caracterización a alta frecuencia(TEC2009-07597)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.
Nº de investigadores/as: 2
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación **Tipo de entidad:** P
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Cód. según financiadora: TEC2009-07597
Fecha de inicio-fin: 01/01/2010 - 31/12/2012 **Duración:** 3 años
Cuantía total: 73.900 €
Régimen de dedicación: Tiempo completo
- 6** **Nombre del proyecto:** MOSFET con canales inhomogéneos: una alternativa para el diseño de nuevas generaciones de dispositivos
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** L
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Rengel, R.
Nº de investigadores/as: 2
Cód. según financiadora: FS/21-2009
Fecha de inicio-fin: 21/12/2009 - 31/12/2010 **Duración:** 1 año - 10 días
Cuantía total: 2.000 €
Régimen de dedicación: Tiempo completo
- 7** **Nombre del proyecto:** Investigación Monte Carlo de Dispositivos MOSFET nanométricos no convencionales para aplicaciones de radiofrecuencia (TEC2008-02266/TEC).
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.
Nº de investigadores/as: 2
Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación **Tipo de entidad:** Pública
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Cód. según financiadora: Tec2008-02266/TEC
Fecha de inicio-fin: 01/01/2009 - 31/12/2009 **Duración:** 1 año
Cuantía total: 8.470 €
Régimen de dedicación: Tiempo completo



- 8 Nombre del proyecto:** Metallic source/drain architecture for advanced MOS technology - METAMOS (IST-016677)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Unión Europea
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Rengel, R.
Nº de investigadores/as: 2
Entidad/es financiadora/s: Unión Europea-
Ciudad entidad financiadora: Bruselas., Bélgica
Cód. según financiadora: IST-016677
Fecha de inicio-fin: 01/09/2005 - 31/03/2009 **Duración:** 3 años - 6 meses
Cuantía total: 156.960 €
Régimen de dedicación: Tiempo completo
- 9 Nombre del proyecto:** Dispositivos MOSFET de Silicio no convencionales: Investigación Monte Carlo de los mecanismos de transporte de carga en transistores ultra-escalados para aplicaciones de alta frecuencia (SA010A07)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Autonómica
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.
Nº de investigadores/as: 2
Entidad/es financiadora/s: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Ciudad entidad financiadora: Valladolid, Castilla y León, España
Cód. según financiadora: SA010A07
Fecha de inicio-fin: 2007 - 2009 **Duración:** 3 años
Cuantía total: 16.050 €
- 10 Nombre del proyecto:** Análisis Monte Carlo del comportamiento a alta frecuencia de dispositivos MOSFET bulk y SOI avanzados (SA008B05).
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Autonómica
Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.
Nº de investigadores/as: 2
Entidad/es financiadora/s: JUNTA DE CASTILLA LEON
Ciudad entidad financiadora: Valladolid, Castilla y León, España
Fecha de inicio-fin: 2005 - 2006 **Duración:** 2 años
Cuantía total: 17.800 €
- 11 Nombre del proyecto:** 18th International Conference on Noise and Fluctuations - ICNF 2005 (TEC2004-20192-E)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional
Entidad de realización: Universidad de Salamanca
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.
Nº de investigadores/as: 7
Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC)



Fecha de inicio-fin: 2005 - 2005

Duración: 1 año

Cuantía total: 9.000 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

12 Nombre del proyecto: EUROSOL. Thematic network on Silicon on Insulator technology, devices and circuits (IST-1-506653-CA)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Unión Europea

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Martín, M. J.

Nº de investigadores/as: 2

Entidad/es financiadora/s:

Unión Europea.

Ciudad entidad financiadora: Bruselas., Bélgica

Fecha de inicio-fin: 2004 - 2005

Duración: 2 años

Cuantía total: 368.000 €

13 Nombre del proyecto: Red Española de Nanotecnología - NANOSPAIN (MAT2001-5411-E)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Nacional

Entidad de realización: Universidad de Salamanca

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Nº de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s:

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Fecha de inicio-fin: 2003 - 2004

Duración: 2 años

Cuantía total: 30.000 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

14 Nombre del proyecto: Análisis Monte Carlo de ruido electrónico a alta frecuencia en materiales y dispositivos semiconductores submicrométricos (SA 057/02)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Autonómica

Entidad de realización: Universidad de Salamanca

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Nº de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s:

JUNTA DE CASTILLA LEON

Fecha de inicio-fin: 2002 - 2004

Duración: 3 años

Cuantía total: 31.562 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

15 Nombre del proyecto: Diseño, simulación y optimización de dispositivos electrónicos para aplicaciones de alta frecuencia y bajo ruido (TIC2001-1754)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Nacional

Entidad de realización: Universidad de Salamanca

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Nº de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s:

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA



Fecha de inicio-fin: 2002 - 2004

Duración: 3 años

Cuantía total: 77.825 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

16 Nombre del proyecto: Network of Excellence on Nanoelectronics - PHANTOMS (IST-2000-26021)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Unión Europea

Entidad de realización: Universidad de Salamanca

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Nº de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s:

COMISIÓN EUROPEA

Ciudad entidad financiadora: Bruselas., Bélgica

Fecha de inicio-fin: 2001 - 2003

Duración: 3 años

Régimen de dedicación: Tiempo completo

17 Nombre del proyecto: Modelización y simulación de dispositivos electrónicos de heterounión con dimensiones nanométricas y aplicación en RF y microondas (SA 44/99)

Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional

Ámbito geográfico: Autonómica

Entidad de realización: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Pardo, D.

Nº de investigadores/as: 8

Entidad/es financiadora/s:

JUNTA DE CASTILLA LEON

Fecha de inicio-fin: 01/01/1999 - 31/12/2001

Duración: 3 años

Cuantía total: 37.340 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

18 Nombre del proyecto: Modelización y simulación de dispositivos electrónicos de heterounión con dimensiones nanométricas". (PB 97-1331)

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Pardo Collantes, D.

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Educación y Ciencia

Fecha de inicio-fin: 1998 - 2001

Cuantía total: 25.723 €

19 Nombre del proyecto: Caracterización y modelización de MODFET de Si/SiGe para aplicaciones analógicas de bajo consumo (HB1998-0057)

Entidad de realización: Imperial College of Science, Technology and Medicine.

Ciudad entidad realización: Reino Unido

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Velázquez, J. E.

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Educación y Cultura.

Fecha de inicio-fin: 1999 - 1999

Cuantía total: 3.485 €

20 Nombre del proyecto: Diseño y simulación de dispositivos electrónicos activos con aplicación en circuitos integrados de microondas. (SA11/96)

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Pardo Collantes, D.



Fecha de inicio-fin: 1997 - 1999

Cuantía total: 15.114 €

21 Nombre del proyecto: SIGMA. SiGe for mobile Communication Applications. Project 01 M 2975

Entidad de realización: TU DELFT

Ciudad entidad realización: Delft., Holanda

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Maria Jesus Martin Martinez

Nº de investigadores/as: 12

Entidad/es financiadora/s:

Unión europea

Ciudad entidad financiadora: Bruselas., Bélgica

Fecha de inicio-fin: 1997 - 1999

Cuantía total: 17.460.000 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

22 Nombre del proyecto: Estudio y modelización de MOSFET avanzados Sub-0.1 µm para aplicaciones analógicas: evaluación del impacto de las heteroestructuras IV-IV (HF1998-0148)

Ciudad entidad realización: Universidad Paris XI, CNRS., Francia

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Velázquez, J. E.

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Educación y Cultura.

Fecha de inicio-fin: 1998 - 1998

Cuantía total: 3.876 €

23 Nombre del proyecto: Diseño y Simulación De Dispositivos Electrónicos Activos Con Aplicación En Las Bandas De Microondas y Milimétricas (Tic95-0652)

Ciudad entidad realización: Salamanca, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Fecha de inicio-fin: 1995 - 1998

Cuantía total: 34.378 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

24 Nombre del proyecto: Desarrollo De Algoritmos Para El Cálculo Numérico De Fluctuaciones Eléctricas En Estructuras Microelectrónicas Avanzadas (Hf1997-0051)

Ciudad entidad realización: Université Montpellier II, Francia

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González Sánchez, T.

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Educación y Cultura.

Fecha de inicio-fin: 1997 - 1997

Cuantía total: 2.524 €

25 Nombre del proyecto: Desarrollo De Algoritmos Para El Cálculo Numérico De Fluctuaciones Eléctricas En Estructuras Microelectrónicas Avanzadas (Hf1996-0133)

Ciudad entidad realización: Université Montpellier II, Francia

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): González, T.

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Educación y Cultura.

Fecha de inicio-fin: 1996 - 1996

Cuantía total: 1.983 €



Régimen de dedicación: Tiempo completo

- 26** **Nombre del proyecto:** UEX Nanoelectrónica y Nanomateriales (NANOLAB)
Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional **Ámbito geográfico:** Nacional
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Mercedes Velazquez Salicio
Nº de investigadores/as: 28
Entidad/es financiadora/s: salamanca **Tipo de entidad:** Universidad
Cód. según financiadora: TEC2016-80839-P
Fecha de inicio: 01/07/2017 **Duración:** 3 años
Régimen de dedicación: Tiempo completo

Contratos, convenios o proyectos de I+D+i no competitivos con Administraciones o entidades públicas o privadas

- 1** **Nombre del proyecto:** Programa de Inspección y optimización de sistemas electrónicos en instalaciones de frío industrial
Grado de contribución: Coordinador del proyecto total, red o consorcio
Nº de investigadores/as: 1
Fecha de inicio: 01/09/2016 **Duración:** 15 meses
Cuantía total: 8.000 €
- 2** **Nombre del proyecto:** Tercera Fase del proyecto SIGMA
Grado de contribución: Coordinador del proyecto total, red o consorcio
Nº de investigadores/as: 1
Entidad/es financiadora/s: Comisión Europea **Tipo de entidad:** Organismo, Otros
Ciudad entidad financiadora: Holanda
Fecha de inicio: 01/02/1999 **Duración:** 9 meses
Cuantía total: 5.880 €
- 3** **Nombre del proyecto:** Diseño, Layout y medida de filtros activos sintonizables monolíticos de Silicio Germanio para aplicaciones en GSM y DECT
Grado de contribución: Coordinador del proyecto total, red o consorcio
Nº de investigadores/as: 1
Entidad/es financiadora/s: Comisión Europea **Tipo de entidad:** Organismo, Otros
Fecha de inicio: 01/01/1998 **Duración:** 15 meses
Cuantía total: 10.339 €



Obras artísticas dirigidas

- 1** **Descripción:** Tipo de evento: Ferias y exhibiciones.
Nombre de la exposición: 2ª Fase de Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Autores/as (p. o. de firma): Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.; Roco J. M.
Ciudad de celebración: Salamanca,
Foro donde se expone: Facultad de Ciencias. Edificio Físicas (Claustro Trilingue).
Monográfica: Si
Fecha de inicio: 01/02/2019
- 2** **Descripción:** Tipo de evento: Ferias y exhibiciones.
Nombre de la exposición: La Gran Revolución de la Electrónica
Autores/as (p. o. de firma): Martin M. J.; González, T.; Rengel, R.; Mateos, J.; Pascual, E.; Iñiguez de la Torre, I.; G. Vasallo, B
Ciudad de celebración: Salamanca, Castilla y León, España
Foro donde se expone: Hospedería Fonseca
Monográfica: Si
Fecha de inicio: 09/11/2018
- 3** **Descripción:** Tipo de evento: Ferias y exhibiciones.
Nombre de la exposición: Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Autores/as (p. o. de firma): Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.; Roco J. M.
Ciudad de celebración: Salamanca,
Foro donde se expone: Facultad de Ciencias. Edificio Físicas (Claustro Trilingue).
Monográfica: Si
Fecha de inicio: 01/02/2016
- 4** **Descripción:** Catalogo exposición 79 páginas
Nombre de la exposición: Realización del catálogo de la Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Autores/as (p. o. de firma): Roco J. M.; Iñiguez de la Torre J. I.; Martin M. J.
Ciudad de celebración: Salamanca,
Foro donde se expone: Facultad de Ciencias. Edificio Físicas (Claustro Trilingue).
Monográfica: Si
Fecha de inicio: 01/09/2014
Título de la publicación: Antiguos aparatos de medida de los laboratorios de física



Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

Índice H: 13

Fecha de aplicación: 20/12/2018

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

- 1** Pascual; Iglesias; Martín; Rengel. Harmonic Extraction in Graphene: Monte Carlo Analysis of the Substrate Influence. *Materials*. 14, pp. 5108. DMPi, 09/2021.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 2** Iglesias; Pascual; Martín; Rengel. High order harmonic generation in 2D transition metal disulphides. *Applied Physics Letters*. 119, pp. 012101. 07/2021.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 3** Jose Manuel Iglesias; Pascual Corral, Elena; Maria Jesus Martin Martinez; Raul Rengel. Relevance of collinear processes to the ultrafast dynamics of photoexcited carriers in graphene. *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*. 123 - 114211, 09/2020.
Tipo de producción: Artículo científico
- 4** Raul Rengel; Oscar Castelló; Pascual Corral, Elena; Maria Jesus Martin Martinez; Jose Manuel Iglesias. Monte Carlo study of noise velocity fluctuations and microscopic carrier transport in monolayer transition metal dichalcogenides. *Journal of Physics D: Applied Physics*. 53 - 395102, 07/2020.
Tipo de producción: Artículo científico
- 5** Pascual Corral, Elena; Jose Manuel Iglesias; Maria Jesus Martin Martinez; Raul Rengel. Electronic transport and noise characterization in MoS₂. *Semiconductor Science and Technology*. 34 - 065011, 03/2020.
Tipo de producción: Artículo científico
- 6** Jose Manuel Iglesias; Pascual Corral, Elena; El Moktar Hamham; Maria Jesus Martin Martinez; Raul Rengel. Interband scattering-induced ambipolar transport in graphene. *Semiconductor Science and Technology*. 34 - 065011, 05/2019.
Tipo de producción: Artículo científico
- 7** Jose Manuel Iglesias; El Moktar Hamham; Pascual Corral, Elena; Raul Rengel; Maria Jesus Martin Martinez. Monte Carlo investigation of noise and high-order harmonic extraction in graphene. *Semiconductor Science and Technology*. 33 - 124012, 11/2018.
Tipo de producción: Artículo científico
- 8** El Moktar Hamham; Jose Manuel Iglesias; Pascual Corral, Elena; Maria Jesus Martin Martinez; Raul Rengel. Impact of the hot phonon effect on electronic transport in monolayer silicene. *Journal of Physics D: Applied Physics*. 51 - 415102, 09/2018.
Tipo de producción: Artículo científico



- 20** Rengel, R.; Martín, M. J.. Diffusion coefficient, correlation function and power spectral density of velocity fluctuations in monolayer graphene. *Journal of applied physics*. pp. 143702. 10/2013.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 21** Martín, M. J.; Pascual Corral; Rengel, R.. RF dynamic and noise performance of Metallic Source/Drain SOI n-MOSFETs. *Solid-state electronics*. 73, pp. 64 - 73. 07/2012.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 22** Rengel; Martín; Danneville. Microscopic modelling of RF noise in Laterally Asymmetric Channel MOSFETs. *IEEE Electron Device Letters*. 32/1, pp. 72 - 74. (Estados Unidos de América): 01/2011. ISSN 0741-3106
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 23** Rengel; Martín. Electronic Transport in Laterally Asymmetric Channel MOSFET for RF Analog Applications. *IEEE Transactions on Electron Devices*. 57 - 10, pp. 2448 - 2454. (Estados Unidos de América): 10/2010. ISSN 0018-9383
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 24** Pascual Corral; Martín, M. J.; Rengel, R.; Larrieu; Dubois. Enhanced carrier injection in Schottky contacts using dopant segregation: A Monte Carlo research. *Semiconductor science and technology*. 24, pp. 25022 - 25027. 20/01/2009.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 25** Pascual; Rengel; Reckinger; Tang; Bayot; Dubois; Martín Martínez. A Monte Carlo investigation of carrier transport in fabricated back-to-back Schottky diodes: Influence of direct quantum tunnelling and temperature. *Physica Status Solidi (c) - current topics in solid-state physics*. 5 - 1, pp. 119 - 122. 01/2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 26** Martín; Rengel; Pascual; Lusakowski; Knap; Tomás González. Onset of quasi-ballistic transport and mobility degradation in ultra scaled MOSFETs: a Monte Carlo study. *Physica Status Solidi (c): current topics in solid-state physics*. 5 - 1, pp. 123 - 126. 01/2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 27** Pascual; Rengel; Martín. Microscopic modelling of reverse biased Schottky diodes: influence of non-equilibrium transport phenomena. *Semiconductor Science and Technology*. 22 - 9, pp. 1003 - 1009. (Reino Unido): 09/2007. ISSN 0268-1242
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 28** Lusakowsky; Martín; Rengel; González; Tauk; Meziani; Knap; Boeuf; Skotnicki. Quasiballistic transport in nanometer Si metal-oxide-semiconductor field-effect transistors: Experimental and Monte Carlo analysis. *Journal of Applied Physics*. 101, pp. 114511. (Estados Unidos de América): 06/2007. ISSN 0021-8979
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 29** Rengel; Pascual; Martín. Injected current and quantum transmission coefficient in low Schottky barriers: WKB and Airy approaches. *IEEE Electron Device Letters*. 28 - 2, pp. 171 - 173. (Estados Unidos de América): 02/2007. ISSN 0741-3106
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 30** Rengel; Martín; Dambrine; Danneville. A Monte Carlo investigation of the RF performance of Partially-Depleted SOI MOSFETs. *Semiconductor Science and Technology*. 21 - 3, pp. 273 - 278. (Reino Unido): 03/2006. ISSN 0268-1242
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 31** Rengel; Martín; González; Mateos; Pardo; Dambrine; Raskin; Danneville. A microscopic interpretation of the RF noise performance of fabricated FDSOI MOSFETs. IEEE Transactions on Electron Devices. 53 - 3, pp. 523 - 532. (Estados Unidos de América): 03/2006. ISSN 0018-9383
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 32** Rengel; González; Martín. On the Influence of Space-Quantization Effects on the RF Noise Behaviour of DG MOSFETs. Fluctuation and Noise Letters. 4 - 4, pp. 561 - 569. (Singapur): 12/2004. ISSN 0219-4775
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 33** Rengel, R.; Pardo, D.; Martín, M. J.. 2D ensemble Monte Carlo modelling of bulk and FD SOI MOSFETs: active layer thickness and noise performance. Semiconductor science and technology. 19, pp. 199 - 201. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 34** Rengel, R.; Pardo, D.; Martín, M. J.. A physically based investigation of the small-signal behaviour of bulk and fully-depleted silicon-on-insulator MOSFETs for microwave applications. Semiconductor science and technology. 19, pp. 634 - 643. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 35** Rengel, R.; Pardo, D.; Martín, M. J.. Towards the nanoscale: influence of scaling on the electronic transport and small-signal behaviour of MOSFET. Nanotechnology. 15, pp. 276 - 282. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 36** Raúl; Javier; Daniel; Tomás; María Jesús; G. Dambrine; F. Danneville; J.P. Raskin. Numerical and experimental study of a 0.25µm fully-depleted silicon-on-insulator MOSFET: static and dynamic radio-frequency behaviour. Semiconductor science and technology. 17 - 11, pp. 1149 - 1156. (Reino Unido): 11/2002. ISSN 0268-1242
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 37** Martín, M. J.; S. Pérez; Pardo, D.; T. González. Influence of Ge profile on the noise behavior of SiGe HBTs under high injection conditions. Physica b. 314, pp. 381 - 385. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 38** Rengel, R.; J. Mateos; Pardo, D.; T. González; Martín, M. J.. RF noise in a short-channel n-MOSFET: a Monte Carlo study. Materials science forum. 384-385, pp. 155 - 158. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 39** Rengel; Mateos; Pardo; González; Martín. Monte Carlo analysis of dynamic and noise performance of submicron MOSFETs at RF and microwave frequencies. Semiconductor science and technology. 16 - 11, pp. 939 - 946. (Reino Unido): 11/2001. ISSN 0268-1242
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 40** Sylvain Barraud; Philippe Dollfus; Sylvie Galdin; Raúl Rengel; María J. Martín; Jesús Enrique Velázquez. An ionised-impurity scattering model for 3D Monte Carlo device simulation with discrete impurity distribution. VLSI design. 13 - 1-4, pp. 399. (Estados Unidos de América): 01/2001. ISSN 1065-514X
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 41** Martín, M. J.; S. Pérez; Pardo, D.; T. González. High injection effects on noise characteristics of Si BJT's and SiGe HBT's. Microelectronics and reliability. 41, pp. 847 - 854. (Reino Unido): 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 42** Martín, M. J.; S. Pérez; Pardo, D.; T. González. Monte Carlo analysis of the noise behavior in Si BJTs and SiGe HBTs at RF frequencies. Journal of applied physics. 90/3, pp. 1582 - 1588. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 43** Martín, M. J.; Pardo, D.; Velázquez, J. E.. Microscopic analysis of the influence of uniform and graded Ge profiles on the current-noise operation mode of n-Si/p-Si_{1-x}Gex heterostructures. Semiconductor science and technology. 15, pp. 277 - 285. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 44** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Microscopic analysis of voltage noise operation mode in SiGe/Si bipolar heterojunctions: Influence of the SiGe strained layer. Journal of applied physics. 88, pp. 1511 - 1514. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 45** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. 2D bipolar Monte Carlo calculation of current fluctuations at the onset of quasisaturation of an Si BJT. Physica b. 272, pp. 263 - 266. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 46** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Microscopic analysis of the influence of strain and band-gap offsets on noise characteristics in Si_{1-x}Gex/Si heterojunctions. Journal of applied physics. 84, pp. 5012 - 5020. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 47** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Analysis of voltage noise in forward-biased silicon bipolar homojunctions: low and high injection regimes. Applied physics letters. 71, pp. 3382 - 3384. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 48** P. Golinelli; R. Brunetti; L. Varani; J.C. Vaissiere; J.P. Nougier; L. Reggiani; E. Starikov; P. Shiktorov; V. Gruzinskis; T. González; Martín, M. J.; Pardo, D.. Hot-carrier thermal conductivity from the simulation of submicron semiconductor structures. Semiconductor science and technology. 12, pp. 1511 - 1513. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 49** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Study of current mode noise in Si/Si_{1-x}Gex strained heterojunctions. Physica status solidi b-basic research. 204, pp. 462 - 464. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 50** Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Analysis of current fluctuations in Silicon pn+ and p+n homjunctions. Journal of applied physics. 79, pp. 6975 - 6981. 1996.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 51** E. Starikov; P. Shiktorov; V. Gruzinskis; T. González; Martín, M. J.; Pardo, D.; L. Reggiani; L. Varani. Hydrodynamic and Monte Carlo simulation of steady-state transport and noise in submicrometer n+nn+ Silicon structures. Semiconductor science and technology. 11, pp. 865 - 872. 1996.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 52** Martín, M. J.; T. González; Pardo, D.; J.E. Velázquez. Monte Carlo analysis of a Schottky diode with an automatic space-variable charge algorithm. Semiconductor science and technology. 11, pp. 380 - 387. 1996.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 53** Martín, M. J.; T. González; Pardo, D.; J.E. Velázquez. One-dimensional Monte Carlo analysis of electron transport in submicron silicon structures. Semiconductor science and technology. 9, pp. 1316 - 1323. 1994.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 54** Martín, M. J.; J.E. Velázquez; T. González; Pardo, D.. Simulation of electron transport in Silicon: Impact-Ionization processes. Semiconductor science and technology. 8, pp. 1291 - 1297. 1993.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 55** Iglesias; Martín; Pascual; Rengel. Carrier-carrier and carrier-phonon interactions in the dynamics of photoexcited electrons in graphene. Journal of Physics: Conference series. 647, pp. 012003-1 - 012003-4. 10/2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 56** R. Rengel; J. M. Iglesias; E. Pascual; M. J. Martín. Effect of charged impurity scattering on the electron diffusivity and mobility in graphene. Journal of Physics: Conference series. 647, pp. 012046-1 - 012046-4. 10/2015.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 57** Martín; Couso; Rengel. Velocity and momentum fluctuations in Suspended Monolayer Graphene. Proceedings of the 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), 2013. pp. 1 - 4. IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERS, INC., 06/2013. ISBN 978-1-4799-0668-0
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 58** Rengel; Martín. A Monte Carlo Study of Electron Transport in Suspended Monolayer Graphene. Proceedings of the 2013 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 175 - 178. 02/2013. ISBN 978-1-4673-4668-9
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 59** Couso; Rengel; Martín; Pascual E.. Schottky Barrier MOSFETs working in the linear regime: A Monte Carlo study of microscopic transport. Proceedings of the 2013 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 63 - 66. 02/2013. ISBN 978-1-4673-4668-9
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 60** Garcia J. S.; Martín; Rengel. Space quantization effects in Double Gate SB-MOSFETs: role of the active layer thickness. Proceedings of the 2013 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 59 - 62. 02/2013. ISBN 978-1-4673-4668-9
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 61** Couso; Pascual; Galeote; Martín; Rengel. Effect of the dopant segregation layer on the static characteristics of Schottky-Barrier n-MOSFETs. Proceedings of the 8th International Caribbean Conference on Devices Circuits and Systems, ICCDCS 2012. pp. 1 - 4. 03/2012.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 62** Pascual; Rengel; Martín. Influence of the underlap length on the RF noise performance of a Schottky Barrier MOSFET. Proceedings of the 21st International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2011). pp. 230 - 233. 06/2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 63** Galeote; Rengel; Pascual; Martín. A Monte Carlo model for the study of n-type strained Silicon Schottky devices. Proceedings of the Spanish Conference on Electron Devices CDE 2011. 02/2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 64** Martín; Rengel; Galeote; de Souza; Pavanello. Monte Carlo simulation of graded-channel fully depleted SOI nMOSFETs. Proceedings of the Spanish Conference on Electron Devices CDE 2011. 02/2011.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 65** Pascual; Martín; Rengel. Intrinsic noise sources in a Schottky Barrier MOSFET: a Monte Carlo Analysis. Proceedings of the 20th International Conference on Noise and Fluctuations. AIP Conference Proceedings. 1129.pp. 329 - 332. (Estados Unidos de América): AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP), 06/2009.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 66** Rengel; Martín; Danneville. Comparative study of Laterally Asymmetric Channel and conventional MOSFETs. Proceedings of the Spanish Conference on Electron Devices CDE 2009. pp. 96 - 99. 02/2009.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro



- 67** Pascual; Martín; Rengel. Current drive in n-type Schottky Barrier MOSFETs: a Monte Carlo study. Proceedings of the Spanish Conference on Electron Devices CDE 2009. pp. 108 - 111. 02/2009.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 68** Martín; Rengel; Pascual; González. RF Noise and Scaling in Nanometer SOI MOSFETs: Influence of Quasiballistic Transport. Proceedings of the 19th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2007) AIP Conference Proceedings. 922, pp. 99 - 102. 09/2007.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 69** Martín; Rengel; Pascual; González. Monte Carlo analysis of carrier transport from diffusive to ballistic regime in nanometer SOI MOSFETs. Proceedings of the 2007 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 340 - 343. 02/2007.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 70** Pascual; Rengel; Martín. Monte Carlo analysis of quantum tunneling and thermionic transport in a reverse biased Schottky diode. Proceedings of the 2007 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 108 - 111. 02/2007.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 71** Rengel; Martín; G. Paillony; G. Dambrine; F. Danneville. On the high-frequency noise figures of merit and microscopic channel noise sources in fabricated 90 nm PD SOI MOSFETs. AIP Conference Proceedings. 780, pp. 745 - 748. (Estados Unidos de América): AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP), 08/2005. ISBN 0-7354-0267-1
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 72** Rengel; Martín; Paillony; Dambrine; Danneville. Monte Carlo characterization of fabricated Partially-Depleted SOI MOSFETs: high-frequency performance. Proceedings of the 2005 Spanish Conference on Electron Devices. pp. 373 - 376. IEEE, 02/2005. ISBN 0-7803-8811-9
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 73** Rengel; Pardo; Martín. Influence of 2D electrostatic effects on the high-frequency noise behaviour of sub-100 nm scaled MOSFETs. Proceedings of the SPIE. 5470, pp. 96 - 106. (Estados Unidos de América): SPIE - The International Society for Optical Engineering, 05/2004.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 74** Rengel; González; Martín. Monte Carlo particle-based simulation of DG MOSFETs: influence of space-quantization effects on the high-frequency noise. Proceedings of the SPIE. 5470, pp. 519 - 528. (Estados Unidos de América): SPIE - The International Society for Optical Engineering, 05/2004.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 75** Rengel; Mateos; Pardo; González; Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J. P. Raskin. Microscopic analysis of the high-frequency noise behavior of fabricated Fully-Depleted SOI MOSFETs. Proceedings of the 17th International Conference on Noise and Fluctuations. pp. 585 - 588. (República Checa): CNRL SRO, 07/2003. ISBN 80-239-1005-1
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 76** Rengel; Mateos; Pardo; González; Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J. P. Raskin. High-frequency noise in FDSOI MOSFETs: a Monte Carlo investigation. Proceedings of the SPIE. 5113, pp. 379 - 386. (Estados Unidos de América): SPIE - The International Society for Optical Engineering, 05/2003. ISBN 0-8194-4973-3
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro



- 77** González; Mateos; Martín; Pérez; Rengel; G. Vasallo; Pardo. Monte Carlo simulation of noise in electronic devices: limitations and perspectives. AIP Conference Proceedings. 665, pp. 496 - 503. (Estados Unidos de América): AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (AIP), 05/2003. ISBN 0-7354-0127-6
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 78** Rengel; Pardo; Martín. Comparative Study of the Dynamic Performance of Bulk and FDSOI MOSFET by means of a Monte Carlo Simulation. PV 2003-05 Silicon-on-Insulator Technology and Devices XI. pp. 283 - 288. (Estados Unidos de América): The Electrochemical Society, Inc., 04/2003. ISBN 1-56677-375-X
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 79** Rengel; Mateos; Pardo; González; Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J. P. Raskin. Dynamic and noise behavior of short-gate FDSOI MOSFETs: numerical and experimental analysis. CDE 2003, 4ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. pp. 1 - 4. SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL CSIC, 02/2003. ISBN 84-607-6770-1
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 80** Rengel; Pardo; Martín. Impact of downscaling on dynamic and noise parameters of submicron MOSFETs. CDE 2003, 4ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. pp. 1 - 4. SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL CSIC, 02/2003. ISBN 84-607-6770-1
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 81** Raúl Rengel; María Jesús Martín; Daniel Pardo. Monte Carlo analysis of a 0.3 μm gate length MOSFET. Actas de la Conferencia de Dispositivos Electrónicos 2001. pp. 21 - 24. 02/2001.
Depósito legal: GR-133-2001
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 82** Rengel; Velázquez; Martín. Microscopic analysis of the influence of high doping and Strain on electron transport in SiGe/Si and Si/SiGe. Actas de la Conferencia de Dispositivos Electrónicos 1999. pp. 167 - 170. Comité Organizador, 06/1999. ISBN 84-00-07819-5
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 83** T. González; Velázquez, J. E.; Martín, M. J.; J. Mateos; Pardo, D.. Actas de la Conferencia de Dispositivos Electrónicos 1997. Simulación microscópica de propiedades de transporte y ruido electrónico en dispositivos semiconductores. pp. 445 - 450. SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UPC (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA), 1997.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 84** Martín, M. J.; Pardo, D.; Velázquez, J. E.. Actas de la conferencia de dispositivos electrónicos. Servicio de publicaciones de la UPC. Estudio Monte Carlo del ruido en heterouniones Si/Si_{1-x}Ge_x. pp. 35 - 40. 1997.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 85** Martín, M. J.; Pardo, D.; Velázquez, J. E.. Proceedings of the 27th European Solid-State Device Research Conference. Monte Carlo comparative study of current-mode noise in Si/Si_{1-x}Ge_x strained heterojunctions. 1, pp. 340 - 343. EDITIONS FRONTIÈRES, 1997.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 86** L. Reggiani; P. Shiktorov; V. Gruzinskis; E. Starikov; L. Varani; T. González; Martín, M. J.; Pardo, D.. Proceedings of the 26th European Solid State Device Research Conference. Hydrodynamic modelling of transport and noise spectra in n⁺nn⁺ semiconductor structures. pp. 295 - 298. EDITIONS FRONTIÈRES, 1996.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro

- 87** L. Reggiani; P. Golinelli; A. Greiner; C. Pennetta; V. Gruzinskis; E. Starikov; P. Shiktorov; L. Varani; J. C. Vaissiere; J. P. Nougier; T. González; Martín, M. J.; Velázquez, J. E.. Proceedings of the Third ELEN Workshop. Advances in noise modelling of high-field transport in semiconductor materials and devices. pp. 89 - 95. IMEC, 1996.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 88** Tomás González Sánchez; Maria Jesus Martin Martinez; Javier Mateos López. Special Issue on Terahertz Devices. Semiconductor Science and Technology. 35 - 4, 02/2020.
Tipo de producción: Libro o monografía científica
- 89** Martín, M. J.. Informe interno Proyecto SIGMA Active microwave filters: State of the art:10-2-99, 4 pag.10/02/1999.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 90** Martín, M. J.. Informe de Progreso proyecto SIGMA Numero 5: Desde 1-1-99 hasta 31-6-99, 5 pags. 1999.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 91** Martín, M. J.. Active Microwave filters and their components using SiGe technology. SIGMA Project, Informe interno ECTM-MC98. 30 pag.09/12/1998.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 92** Martín, M. J.. Informe de Progreso proyecto SIGMA Numero 4: Desde 1-7-98 hasta 31-12-98, 4 pag. 01/07/1998.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 93** Martín, M. J.. Informe de Progreso proyecto SIGMA Numero 3: Desde 1-1-98 hasta 31-6-98, 4 pag. 1998.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 94** Martín, M. J.. Informe de Progreso proyecto SIGMA Numero 2: Desde 1-7-97 hasta 31-12-97, 3 pag.01/07/1997.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro
- 95** Martín, M. J.. Informe de Progreso proyecto SIGMA Numero 1, Desde 1-1-97 hasta 31-6-97, 3 pag.1997.
Tipo de producción: Informe científico-técnico **Tipo de soporte:** Libro

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

- 1** **Título del trabajo:** Monte Carlo Simulations for 2D Materials: Parallelization Strategy and Degeneracy in MoS₂
Nombre del congreso: ImagineNano 2020, Bilbao, Spain, April 2020.
Ciudad de celebración: Nara, Japón
Fecha de celebración: 10/04/2020
E. Pascual; J. M. Iglesias; M. J. Martin; R. Rengel; Karol Kalna.
- 2** **Título del trabajo:** Collinear scattering in the relaxation dynamics of photoexcited graphene
Nombre del congreso: EDISON 2019 (Nara, Japan, July 2019)
Ciudad de celebración: Nara, Japón
Fecha de celebración: 14/07/2019
J. M. Iglesias; M. J. Martin; E. Pascual; Hamham, El Moktar; R. Rengel.

- 3** **Título del trabajo:** Microscopic analysis of electronic transport in MoS₂
Nombre del congreso: EDISON 2019 (Nara, Japan, July 2019)
Ciudad de celebración: Nara, Japón
Fecha de celebración: 14/07/2019
E. Pascual; J. M. Iglesias; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; R. Rengel.
- 4** **Título del trabajo:** Impact ionization and Auger recombination in graphene under stationary electric fields
Nombre del congreso: Graphene Conference 2019
Ciudad de celebración: Rome, Italia
Fecha de celebración: 24/06/2019
J. M. Iglesias; E. Pascual; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; R. Rengel.
- 5** **Título del trabajo:** Diffusive electronic transport in MoS₂: a Monte Carlo study
Nombre del congreso: 12th Spanish Conference on Electron Devices (CDE2018)
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 13/09/2018
E. Pascual; J. M. Iglesias; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; R. Rengel.
- 6** **Título del trabajo:** The Role of interband processes on electronic transport in monolayer graphene
Nombre del congreso: 12th Spanish Conference on Electron Devices (CDE2018)
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 13/09/2018
J. M. Iglesias; E. Pascual; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; R. Rengel.
- 7** **Título del trabajo:** A Monte Carlo study of electronic transport in silicene: importance of out-of-equilibrium phonons
Nombre del congreso: ImagineNano 2018
Ciudad de celebración: Biilbao, España
Fecha de celebración: 10/03/2018
Hamham, El Moktar; J. M. Iglesias; M. J. Martin; R. Rengel.
- 8** **Título del trabajo:** Investigation of high frequency performance of hBN encapsulated Graphene Field-Effect Transistors
Nombre del congreso: ImagineNano 2018
Ciudad de celebración: Biilbao, España
Fecha de celebración: 10/03/2018
Feijoo, Pedro C.; Pasadas, Francisco; J. M. Iglesias; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; R. Rengel; Jimenez, David.
- 9** **Título del trabajo:** Monte Carlo simulation of harmonic generation in graphene under AC applied fields
Nombre del congreso: Graphene Week 2017
Ciudad de celebración: Atenas, Grecia
Fecha de celebración: 13/09/2017
J. M. Iglesias; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; Pascual, Elena; R. Rengel.
- 10** **Título del trabajo:** Graphene encapsulated on h-BN: an analysis of mobility and saturation velocity for GFET operation
Nombre del congreso: 20th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, EDISON 2017
Ciudad de celebración: Buffalo, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 08/07/2017



J. M. Iglesias; Hamham, El Moktar; M. J. Martin; Pascual, Elena; D. Jimenez; P. D. Feijoo; F. Pasadas; R. Rengel.

- 11 Título del trabajo:** Non perturbative high harmonic generation in graphene
Nombre del congreso: X Spanish Optoelectronics Meeting (OPTOEL 2017)
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, España
Fecha de celebración: 22/06/2017
O. Zurrón; J. M. Iglesias; R. Rengel; M. J. Martin; L. Plaja.
- 12 Título del trabajo:** High order harmonic generation in graphene
Nombre del congreso: CLEO Europe 2017 Conference on Lasers and Electro-Optics
Ciudad de celebración: Munich, Alemania
Fecha de celebración: 15/06/2017
O. Zurrón; J. M. Iglesias; R. Rengel; M. J. Martin; L. Plaja.
- 13 Título del trabajo:** A combined Monte Carlo-balance equations approach for the study of small-signal and noise properties of graphene
Nombre del congreso: 11th Spanish Conference on Electron Devices (CDE2017)
Ciudad de celebración: Barcelona, España
Fecha de celebración: 08/02/2017
R. Rengel; J. M. Iglesias; E. Pascual; M. J. Martin.
- 14 Título del trabajo:** Impact of Self-heating and Hot Phonons on the Drift Velocity in Graphene
Nombre del congreso: 11th Spanish Conference on Electron Devices (CDE2017)
Ciudad de celebración: Barcelona, España
Fecha de celebración: 08/02/2017
J. M. Iglesias; M. J. Martin; E. Pascual; R. Rengel.
- 15 Título del trabajo:** Impact of scattering mechanisms and dimensions scaling in Graphene Field-Effect transistors
Nombre del congreso: 11th Spanish Conference on Electron Devices (CDE2017)
Ciudad de celebración: Barcelona, España
Fecha de celebración: 08/02/2017
P. D. Feijoo; F. Pasadas; J. M. Iglesias; M. J. Martin; R. Rengel; D. Jimenez.
- 16 Título del trabajo:** High harmonic generation in graphene: Temporal and spectral properties
Nombre del congreso: Ultrafast Phenomena and Nanophotonics XXI (SPIE OPTO 2017)
Ciudad de celebración: San Francisco, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 30/01/2017
O. Zurrón; J. M. Iglesias; R. Rengel; M. J. Martin; L. Plaja.
- 17 Título del trabajo:** Substrate-dependent Out-of-equilibrium Phonon and Electron Dynamics in Photoexcited Graphene
Nombre del congreso: 7th International Conference on Advanced Nanomaterials (ANM2016)
Ciudad de celebración: Barcelona, España
Fecha de celebración: 08/07/2016
J. M. Iglesias; M. J. Martin; E. Pascual; R. Rengel.
- 18 Título del trabajo:** Monte Carlo study of velocity fluctuations during transient regimes in graphene
Nombre del congreso: 7th International Conference on Unsolved Problems on Noise (UPON2015)
Ámbito geográfico: Internacional no UE



Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Barcelona, España
Fecha de celebración: 13/07/2015
Fecha de finalización: 17/07/2015
José Manuel Iglesias; Raúl Rengel; Elena Pascual; María Jesús Martín.

- 19 Título del trabajo:** A Monte Carlo study on the hot carrier relaxation dynamics in photoexcited graphene
Nombre del congreso: 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON19)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 29/06/2015
Fecha de finalización: 02/07/2015
José Manuel Iglesias; María Jesús Martín; Elena Pascual; Raúl Rengel.
- 20 Título del trabajo:** Effect of charged impurity scattering on the electron diffusivity and mobility in graphene
Nombre del congreso: 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON19)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 29/06/2015
Fecha de finalización: 02/07/2015
Raúl Rengel; José Manuel Iglesias; Elena Pascual; María Jesús Martín.
- 21 Título del trabajo:** High electric field transport in graphene: impact of screened coulomb interactions
Nombre del congreso: Graphene Conference 2015
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Bilbao, España
Fecha de celebración: 10/03/2015
Fecha de finalización: 13/03/2015
José Manuel Iglesias; María Jesús Martín; Raúl Rengel.
- 22 Título del trabajo:** Influence of systematic gate alignment variations on static characteristics in DG-SB-MOSFETs
Nombre del congreso: 10th Spanish Conference on Electron Devices (CDE 2015)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Aranjuez, España
Fecha de celebración: 11/02/2015
Fecha de finalización: 13/02/2015
José Manuel Iglesias; María Jesús Martín; Elena Pascual; Raúl Rengel.
- 23 Título del trabajo:** Monte Carlo modelling of mobility and microscopic transport in supported graphene
Nombre del congreso: 10th Spanish Conference on Electron Devices (CDE 2015)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Aranjuez, España
Fecha de celebración: 11/02/2015



Fecha de finalización: 13/02/2015

Raúl Rengel; José Manuel Iglesias; Elena Pascual; María Jesús Martín.

24 Título del trabajo: Impact of the temperature and remote phonon scattering on charge transport in supported graphene

Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology (TNT) 2014

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Barcelona, España

Fecha de celebración: 27/10/2014

Fecha de finalización: 31/10/2014

Raúl Rengel; Elena Pascual; María Jesús Martín.

25 Título del trabajo: Impact of the Gate Length on the Transport Properties of Graded-Channel SOI n-MOSFETs

Nombre del congreso: 18th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON 18)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Matsue, Japón

Fecha de celebración: 22/07/2013

Fecha de finalización: 26/07/2013

Ciudad entidad organizadora: Matsue, Japón

Martín, M. J.; Rengel, R.; Michelly de Souza; Marcelo Antonio Pavanello.

26 Título del trabajo: Influence of the Dispersion Relationship on Electronic Transport in Suspended Graphene

Nombre del congreso: 18th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON 18)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Matsue, Japón

Fecha de celebración: 22/07/2013

Fecha de finalización: 26/07/2013

Ciudad entidad organizadora: Matsue, Japón

Rengel, R.; Martín, M. J.

27 Título del trabajo: Velocity and momentum fluctuations in Suspended Monolayer Graphene

Nombre del congreso: 22th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2013)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Montpellier, Francia

Fecha de celebración: 24/06/2013

Fecha de finalización: 28/06/2013

Ciudad entidad organizadora: Montpellier, Francia

Rengel, R.; Martín, M. J.

28 Título del trabajo: A Monte Carlo Study of Electron Transport in Suspended Monolayer Graphene

Nombre del congreso: 9ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2013)

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: VALLADOLID, España

Fecha de celebración: 12/02/2013

Fecha de finalización: 14/02/2013

Ciudad entidad organizadora: VALLADOLID, España

Rengel, R.; Carlos Couso Fontanillo; Martín, M. J. "Proceedings of the 2013 Spanish Conference on Electron Devices". pp. 175 - 178. ISBN 978-1-4673-4666-5

29 Título del trabajo: Schottky Barrier MOSFETs working in the linear regime: A Monte Carlo study of microscopic transport

Nombre del congreso: 9ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2013)

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: VALLADOLID, España

Fecha de celebración: 12/02/2013

Fecha de finalización: 14/02/2013

Ciudad entidad organizadora: VALLADOLID, España

Carlos Couso Fontanillo; Rengel, R.; Martín, M. J. "Proceedings of the 2013 Spanish Conference on Electron Devices". pp. 63 - 66. ISBN 978-1-4673-4668-9

30 Título del trabajo: Space quantization effects in Double Gate SB-MOSFETs: role of the active layer thickness

Nombre del congreso: 9ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2013)

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Valladolid, España

Fecha de celebración: 12/02/2013

Fecha de finalización: 14/02/2013

José Santiago García; María Jesús Martín; Raúl Rengel. pp. 59 - 62.

31 Título del trabajo: Effect of the dopant segregation layer on the static characteristics of Schottky-Barrier n-MOSFETs

Nombre del congreso: 8th International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Playa del Carmen, México

Fecha de celebración: 14/03/2012

Fecha de finalización: 17/03/2012

Carlos Couso; Elena Pascual; Jose María Galeote; María Jesús Martín; Raúl Rengel.

32 Título del trabajo: A Monte Carlo study of the influence of scaling in SB-MOSFETs: static and dynamic characteristics

Nombre del congreso: EUROSOI 2012

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Montpellier, Francia

Fecha de celebración: 23/01/2012

Fecha de finalización: 25/01/2012

Jose María Galeote; Elena Pascual; Raúl Rengel; María Jesús Martín.

33 Título del trabajo: Influence of the underlap length on the RF noise performance of a Schottky Barrier MOSFET

Nombre del congreso: 21st International Conference on Noise and Fluctuations



Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Toronto, Canadá
Fecha de celebración: 12/06/2011
Fecha de finalización: 16/06/2011
Elena Pascual; Raúl Rengel; María Jesús Martín.

- 34** **Título del trabajo:** A Monte Carlo model for the study of n-type strained Silicon Schottky devices
Nombre del congreso: 8th Spanish Conference on Electron Devices
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España
Fecha de celebración: 08/02/2011
Fecha de finalización: 11/02/2011
José María Galeote; Raúl Rengel; Elena Pascual; María Jesús Martín. pp. 1 - 4. ISBN 978-1-4244-7863-7
- 35** **Título del trabajo:** Monte Carlo simulation of graded-channel fully depleted SOI nMOSFETs
Nombre del congreso: 8th Spanish Conference on Electron Devices (CDE 2011)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Palma de Mallorca, España
Fecha de celebración: 08/02/2011
Fecha de finalización: 11/02/2011
María Jesús Martín; Raúl Rengel; José María Galeote; Michelly de Souza; Marcelo Antonio Pavanello. pp. 1 - 4. ISBN 978-1-4244-7863-7
- 36** **Título del trabajo:** Metallic Source/Drain Architecture for Advanced MOS Technology: an overview of METAMOS results
Nombre del congreso: 8th Symposium Diagnostics & Yield Advanced Silicon Devices and Technologies for ULSI Era
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Ciudad de celebración: Varsovia, Polonia
Fecha de celebración: 22/06/2009
Fecha de finalización: 24/06/2009
Emmanuel Dubois; Guilhem Larrieu; Nicolas Breil; Raphael Valentin; Dimitri Yarekha; Nicolas Reckinger; Xiaohui Tang; Aomar Halimaoui; Raúl Rengel; Elena Pascual; Arnaud Pouydebasque; Xavier Wallart; Sylvie Godey; Jerzy Ratajczak; Adam Laszcz; Jerzy Katcki; Jean-Pierre Raskin; Gilles Dambrine; Antoine Cros; Thomas Skotnicki.
- 37** **Título del trabajo:** Intrinsic Noise sources in a Schottky Barrier MOSFET: a Monte Carlo analysis.
Nombre del congreso: 20th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2009)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Pisa, Italia
Fecha de celebración: 15/06/2009
Fecha de finalización: 19/06/2009
Elena Pascual; Raúl Rengel; María Jesús Martín.



- 38** **Título del trabajo:** Comparative study of Laterally Asymmetric Channel and conventional MOSFETs
Nombre del congreso: 7ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos. Libro de Comunicaciones en CD
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: SANTIAGO DE COMPOSTELA, España
Fecha de celebración: 11/02/2009
Fecha de finalización: 13/02/2009
Ciudad entidad organizadora: SANTIAGO DE COMPOSTELA, España
Rengel, R.; Martín, M. J.; Francois Danneville. ISBN 978-1-4244-2839-7
- 39** **Título del trabajo:** Current drive in n- type Schottky Barrier MOSFETs: a Monte Carlo study
Nombre del congreso: 7ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2009)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Ciudad de celebración: SANTIAGO DE COMPOSTELA, España
Fecha de celebración: 11/02/2009
Fecha de finalización: 13/02/2009
Ciudad entidad organizadora: SANTIAGO DE COMPOSTELA, España
Elena Pascual Corral; Rengel, R.; Martín, M. J. "Proceedings de la 7ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2009)".
- 40** **Título del trabajo:** Ballistic transport and RF noise in ultra-scaled SOI MOSFETs: a Monte Carlo study
Nombre del congreso: EUROSOI 2008: Fourth Workshop of the Thematic Network on Silicon-on-Insulator Technology, Devices and Circuits
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Cork, Irlanda
Fecha de celebración: 23/01/2008
Fecha de finalización: 25/01/2008
María Jesús Martín; Elena Pascual; Tomás González; Raúl Rengel.
- 41** **Título del trabajo:** RF Noise and Scaling in Nanometer SOI MOSFETs: Influence of Quasiballistic Transport
Nombre del congreso: 19th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 2007)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Tokio, Japón
Fecha de celebración: 09/09/2007
Fecha de finalización: 14/09/2007
María Jesús Martín; Raúl Rengel; Elena Pascual; Tomás González.
- 42** **Título del trabajo:** Monte Carlo analysis of carrier transport in fabricated back-to-back Schottky diodes: influence of direct quantum tunnelling and temperature
Nombre del congreso: 15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS-15)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Tokio, Japón
Fecha de celebración: 23/07/2007
Fecha de finalización: 27/07/2007
Elena Pascual; Raúl Rengel; Nicolas Reckinger; Xiaoui Tang; Vincent Bayot; Emmanuel Dubois; María Jesús Martín.



- 43 Título del trabajo:** Onset of quasi-ballistic transport and mobility degradation in ultra scaled MOSFETs: a Monte Carlo study
Nombre del congreso: 15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS-15)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Tokio, Japón
Fecha de celebración: 23/07/2007
Fecha de finalización: 27/07/2007
María Jesús Martín; Raúl Rengel; Elena Pascual; Jerzy Lusakowsky; Wojciek Knap; Tomás González.
- 44 Título del trabajo:** Monte Carlo analysis of carrier transport from diffusive to ballistic regime in nanometer SOI MOSFETs
Nombre del congreso: 6ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2007)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: San Lorenzo de El Escorial, España
Fecha de celebración: 31/01/2007
Fecha de finalización: 02/02/2007
María Jesús Martín; Raúl Rengel; Elena Pascual; Tomás González.
- 45 Título del trabajo:** Monte Carlo analysis of quantum tunneling and thermionic transport in a reverse biased Schottky diode
Nombre del congreso: 6ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2007)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: San Lorenzo de El Escorial, España
Fecha de celebración: 31/01/2007
Fecha de finalización: 02/02/2007
Elena Pascual; Raúl Rengel; María Jesús Martín.
- 46 Título del trabajo:** A Monte Carlo study of downscaled FD SOI MOSFETs: mean free paths and transit times evaluated through an improved treatment of simulation results
Nombre del congreso: EUROSOI 2006, 2nd Workshop of the Thematic Network on Silicon on Insulator Technology, Devices and Circuits
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Grenoble, Francia
Fecha de celebración: 08/03/2006
Fecha de finalización: 10/03/2006
María Jesús Martín; Raúl Rengel.
- 47 Título del trabajo:** On the high-frequency noise figures of merit and microscopic channel noise sources in fabricated 90 nm PD SOI MOSFETs
Nombre del congreso: 18th International Conference on Noise and Fluctuations - ICNF 2005
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 19/09/2005
Fecha de finalización: 23/09/2005
Raúl Rengel; María Jesús Martín; Guillaume Paillancy; Gilles Dambrine; François Danneville.



- 48** **Título del trabajo:** Statistical investigation of electronic transport in decananometer gatelength SOI MOSFETs
Nombre del congreso: 14th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS-14)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Chicago, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 25/07/2005
Fecha de finalización: 29/07/2005
María Jesús Martín; Raúl Rengel.
- 49** **Título del trabajo:** Investigation of longitudinal velocity fluctuations in MOSFETs by means of ensemble Monte Carlo simulation
Nombre del congreso: 4th International Conference on Unsolved Problems on Noise (UPoN2005)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Gallipoli, Italia
Fecha de celebración: 06/06/2005
Fecha de finalización: 10/06/2005
Raúl Rengel; Javier Mateos; Tomás González; Daniel Pardo; Gilles Dambrine; François Danneville; Jean-Pierre Raskin; María Jesús Martín.
- 50** **Título del trabajo:** Monte Carlo characterization of fabricated Partially-Depleted SOI MOSFETs: high-frequency performance
Nombre del congreso: 5ª Conferencia De Dispositivos Electrónicos (CDE 2005)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Tarragona, España
Fecha de celebración: 02/02/2005
Fecha de finalización: 04/02/2005
Raúl Rengel; María Jesús Martín; Guillaume Pailloncy; Gilles Dambrine; François Danneville.
- 51** **Título del trabajo:** Numerical and experimental investigation of the RF dynamic and noise performance of sub-100 nm Partially-Depleted SOI MOSFETs
Nombre del congreso: First Workshop of the Thematic Network on Silicon on Insulator technology, devices and circuits EUROSOI 2005
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Granada, España
Fecha de celebración: 19/01/2005
Fecha de finalización: 21/01/2005
Raúl Rengel; María Jesús Martín; Guillaume Pailloncy; Gilles Dambrine; François Danneville.
- 52** **Título del trabajo:** Influence of 2D electrostatic effects on the high-frequency noise behaviour of sub-100 nm scaled MOSFETs
Nombre del congreso: 2nd SPIE International Symposium on Fluctuations and Noise
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España
Fecha de celebración: 25/05/2004
Fecha de finalización: 28/05/2004

Raúl Rengel; Daniel Pardo; María Jesús Martín.

- 53 Título del trabajo:** Monte Carlo particle-based simulation of DG MOSFETs: influence of space-quantization effects on the high-frequency noise
Nombre del congreso: 2nd SPIE International Symposium on Fluctuation and Noise (FaN'2004)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Las Palmas de Gran Canaria, España
Fecha de celebración: 25/05/2004
Fecha de finalización: 28/05/2004
Raúl Rengel; Tomás González; María Jesús Martín.
- 54 Título del trabajo:** Towards the nano-scale: influence of scaling on the electronic transport and small-signal behaviour of MOSFETs
Nombre del congreso: Trends in NanoTechnology TNT 2003
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 15/09/2003
Fecha de finalización: 19/09/2003
Raúl Rengel; Daniel Pardo; María Jesús Martín.
- 55 Título del trabajo:** Microscopic analysis of the high-frequency noise behaviour of fabricated Fully-Depleted Silicon-On-Insulator MOSFETs
Nombre del congreso: 17th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 03)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Praga, República Checa
Fecha de celebración: 18/08/2003
Fecha de finalización: 22/08/2003
Raúl Rengel; Javier Mateos; Daniel Pardo; Tomás González; María Jesús Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J.P. Raskin. , CNRL s.r.o. ,2003, pp. 585-588,
- 56 Título del trabajo:** 2D Ensemble Monte Carlo modeling of bulk and FDSOI MOSFETs: active layer thickness and noise performance
Nombre del congreso: 13th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors HCIS13
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Modena, Italia
Fecha de celebración: 28/07/2003
Fecha de finalización: 01/08/2003
Raúl Rengel; Daniel Pardo; María Jesús Martín.
- 57 Título del trabajo:** High-Frequency noise in FDSOI MOSFETs: a Monte Carlo investigation
Nombre del congreso: Noise in Devices and Circuits - 1st Symposium on Fluctuations and Noise (FaN'2003)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santa Fe, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 01/06/2003
Fecha de finalización: 04/06/2003



Raúl Rengel; Javier Mateos; Daniel Pardo; Tomás González; María Jesús Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J.P. Raskin.

58 Título del trabajo: Comparative Study of the Dynamic Performance of Bulk and FDSOI MOSFET by means of a Monte Carlo Simulation

Nombre del congreso: XI Symposium on SOI Technology and Devices

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: París, Francia

Fecha de celebración: 28/04/2003

Fecha de finalización: 02/05/2003

Raúl Rengel; Daniel Pardo; María Jesús Martín.

59 Título del trabajo: Dynamic and Noise Behavior of Short-Gate FDSOI MOSFETs: Numerical and Experimental analysis

Nombre del congreso: 4ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos CDE2003

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Calella, España

Fecha de celebración: 12/02/2003

Fecha de finalización: 14/02/2003

Raúl Rengel; Javier Mateos; Daniel Pardo; Tomás González; María Jesús Martín; G. Dambrine; F. Danneville; J.P. Raskin.

60 Título del trabajo: Impact of downscaling on dynamic and noise parameters of submicron MOSFETs

Nombre del congreso: 4ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos CDE2003

Ámbito geográfico: Nacional

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Calella, España

Fecha de celebración: 12/02/2003

Fecha de finalización: 14/02/2003

Raúl Rengel; Daniel Pardo; María Jesús Martín.

61 Título del trabajo: Monte Carlo simulation of noise in electronic devices: limitations and perspectives

Nombre del congreso: 3rd International Conference on Unsolved Problems on Noise (UPoN'2002)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote

Ciudad de celebración: Washington, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 03/09/2002

Fecha de finalización: 06/09/2002

Tomás González; Javier Mateos; María Jesús Martín; Susana Pérez; Raúl Rengel; Beatriz G. Vasallo; Daniel Pardo.

62 Título del trabajo: Microscopic analysis of microwave noise sources in SiGe HBTs

Nombre del congreso: 16th International Conference on Noise in Physical Systems (ICNF2001)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Gainesville, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 10/2001

Fecha de finalización: 31/10/2001

Ciudad entidad organizadora: Gainesville, Estados Unidos de América



Martín, M. J.; J. Mateos; Pardo, D.; T. González. , World Scientific, 2001, pp. 217-220,

- 63** **Título del trabajo:** RF noise in a short channel n-MOSFET: a Monte Carlo study
Nombre del congreso: 11th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Vilnius, Lituania
Fecha de celebración: 27/08/2001
Fecha de finalización: 29/08/2001
Raúl Rengel; Javier Mateos; Daniel Pardo; Tomás González; María Jesús Martín.
- 64** **Título del trabajo:** Influence of Ge profile on the noise behavior of SiGe HBTs under high injection conditions
Nombre del congreso: 12th International Conference on Non-equilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors (HCIS-12)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santa Fe, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 08/2001
Ciudad entidad organizadora: Santa Fe, Estados Unidos de América
Martín, M. J.; S. Pérez; Pardo, D.; T. González.
- 65** **Título del trabajo:** Monte Carlo analysis of a 0.3- μm gate length MOSFET
Nombre del congreso: 3ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos CDE2001
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Granada, España
Fecha de celebración: 15/02/2001
Fecha de finalización: 16/02/2001
Raúl Rengel; María Jesús Martín.
- 66** **Título del trabajo:** Influence of high-injection conditions on the noise behavior in Si BJT's and SiGe HBT's at RF frequencies
Nombre del congreso: 3ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE 2001)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: GRANADA, España
Fecha de celebración: 02/2001
Fecha de finalización: 28/02/2001
Ciudad entidad organizadora: GRANADA, España
Martín, M. J.; T. González; Pardo, D.
- 67** **Título del trabajo:** Comparative analysis of current fluctuations in Si BJT's and SiGe HBT's
Nombre del congreso: 25th International Conference on the Physics of Semiconductors 2000
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Osaka,
Fecha de celebración: 10/2000
Fecha de finalización: 31/10/2000
Ciudad entidad organizadora: Osaka,
Martín, M. J.; T. González; Pardo, D., SPRINGER VERLAG,



- 68** **Título del trabajo:** Physically Based comparison of current noise analysis of Si BJT's and SiGe HBT's
Nombre del congreso: 30th European Solid-State Device Reserach Conference (ESSDERC'2000)
Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Cork, Irlanda
Fecha de celebración: 09/2000
Fecha de finalización: 30/09/2000
Ciudad entidad organizadora: Cork, Irlanda
Martín, M. J.; Pardo, D.
- 69** **Título del trabajo:** Effet de la nature discrète des atomes d ζ impuretés dans le canal des MOSFET sub-0.1 μ m par simulation Monte Carlo 3D
Nombre del congreso: 1e journée nationale "Impuretés et Défauts dans les composants ultimes
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Orsay, Francia
Fecha de celebración: 05/07/2000
Fecha de finalización: 07/07/2000
Sylvain Barraud; Philippe Dollfus; Sylvie Galdin; Raúl Rengel; María Jesús Martín; Jesús Enrique Velázquez.
- 70** **Título del trabajo:** Effet de la nature discrète des atomes d ζ impuretés dans le canal des MOSFET sub-0.1 μ m par simulation Monte Carlo 3D
Nombre del congreso: 1e journée nationale "Impuretés et Défauts dans les composants ultimes
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Orsay, Francia
Fecha de celebración: 07/2000
Fecha de finalización: 31/07/2000
Ciudad entidad organizadora: Orsay, Francia
S. Barraud; P. Dollfus; S. Galdin; Rengel, R.; Martín, M. J.; J.E. Velázquez.
- 71** **Título del trabajo:** An ionised impurity scattering model for 3-D Monte Carlo device simulation with discrete impurity distribution
Nombre del congreso: 7th International Workshop on Computational Electronics
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Glasgow, Reino Unido
Fecha de celebración: 22/05/2000
Fecha de finalización: 25/05/2000
Sylvain Barraud; Philippe Dollfus; Sylvie Galdin; Raúl Rengel; María Jesús Martín; Jesús Enrique Velázquez.
- 72** **Título del trabajo:** SiGe HBT RF technology for mobile communications : active filters based on bandpass amplifiers
Nombre del congreso: XIII Conference on Design of Circuits an Integrated Systems (DCIS ζ 99)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: PALMA DE MALLORCA, España
Fecha de celebración: 11/1999



Fecha de finalización: 30/11/1999

Ciudad entidad organizadora: PALMA DE MALLORCA, España

Martín, M. J.; J.L. Tauritz.

- 73** **Título del trabajo:** Microscopic Analysis of the influence of High doping and Strain on electron transport in SiGe/Si and Si/SiGe
Nombre del congreso: 2ª Conferencia de Dispositivos Electrónicos CDE1999
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 10/06/1999
Fecha de finalización: 11/06/1999
Raúl Rengel; Jesús Enrique Velázquez; María Jesús Martín.
- 74** **Título del trabajo:** 2D Monte Carlo comparison of bipolar transport and current fluctuations at the onset of quasi-saturation of a Si BJT and a Si/Si_{1-x}Gex/Si HBT
Nombre del congreso: Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE-99)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: MADRID, España
Fecha de celebración: 06/1999
Fecha de finalización: 30/06/1999
Ciudad entidad organizadora: MADRID, España
Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez.
- 75** **Título del trabajo:** 2D bipolar Monte Carlo calculation of current fluctuations at the onset of quasi-saturation of a Si BJT
Nombre del congreso: 11th International Conference on Hot Carriers in Semiconductors (HCIS-11)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Kyoto, Japón
Fecha de celebración: 1999
Fecha de finalización: 31/12/1999
Ciudad entidad organizadora: Kyoto, Japón
Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez.
- 76** **Título del trabajo:** SiGe HBT RF technology for mobile communications : MMIC active filters
Nombre del congreso: Conferencia De Dispositivos Electrónicos (CDE-99)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: MADRID, España
Fecha de celebración: 1999
Fecha de finalización: 31/12/1999
Ciudad entidad organizadora: MADRID, España
Martín, M. J.; J.L. Tauritz.
- 77** **Título del trabajo:** 1.8 GHz Active Microwave Filter realized in SiGe for Mobile Communications
Nombre del congreso: XIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS'98)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: MADRID, España

Fecha de celebración: 17/11/1998
Fecha de finalización: 20/11/1998
Ciudad entidad organizadora: MADRID, España
Martín, M. J.; L.C.N. Vreede; J.L. Tauritz.

- 78** **Título del trabajo:** Microscopic Study of the Influence of SiGe Strained Layer on Voltage Noise Performance in SiGe/Si Bipolar Heterojunctions
Nombre del congreso: XIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS₉₈)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: MADRID, España
Fecha de celebración: 17/11/1998
Fecha de finalización: 20/11/1998
Ciudad entidad organizadora: MADRID, España
Martín, M. J.; Velázquez, J. E.
- 79** **Título del trabajo:** Active microwave filters realized in SiGe Technology
Nombre del congreso: 28th European Microwave Conference (MTT-S European Wireless 98)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Amsterdam. Países Bajos, Holanda
Fecha de celebración: 10/1998
Fecha de finalización: 31/10/1998
Ciudad entidad organizadora: Amsterdam. Países Bajos, Holanda
Martín, M. J.; L.C.N. Vreede; J.L. Tauritz.
- 80** **Título del trabajo:** Etude Monte Carlo de L'influence du gradient de Ge sur la température equivalente du bruit dans les hétérojonctions Si/SiGe pseudomorphiques
Nombre del congreso: 2èmes Journées D'étude, Orsay 21-23 enero 1998
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: París, Francia
Fecha de celebración: 1998
Fecha de finalización: 31/12/1998
Ciudad entidad organizadora: París, Francia
Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez.
- 81** **Título del trabajo:** Filtros MMIC Activos Realizados en Tecnología HBT de SiGe para Comunicaciones Móviles
Nombre del congreso: XIII Simposium Nacional. Unión Científica Internacional de Radio (URSI 98)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: PAMPLONA, España
Fecha de celebración: 1998
Fecha de finalización: 31/12/1998
Ciudad entidad organizadora: PAMPLONA, España
Martín, M. J.; J. Tauritz.
- 82** **Título del trabajo:** Monte Carlo Comparative Study of Current-Mode Noise in Si/Si_{1-x}Ge Strained Heterojunctions
Nombre del congreso: 27th European Solid-State Device Research Conference ESSDERC'97



Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Stuttgart, Alemania
Fecha de celebración: 09/1997
Fecha de finalización: 30/09/1997
Ciudad entidad organizadora: Stuttgart, Alemania
Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez.

83 Título del trabajo: Study of current mode noise in Si/Si_{1-x}Gex strained heterojunctions
Nombre del congreso: 10th International Conference on Hot Carriers in Semiconductors (HCIS-10)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Berlín, Alemania
Fecha de celebración: 07/1997
Fecha de finalización: 31/07/1997
Ciudad entidad organizadora: Berlín, Alemania
Martín, M. J.; Pardo, D.; J.E. Velázquez.

84 Título del trabajo: Estudio Monte Carlo del ruido en heterouniones Si/Si_{1-x}Gex
Nombre del congreso: Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE-97)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: BARCELONA, España
Fecha de celebración: 02/1997
Fecha de finalización: 28/02/1997
Ciudad entidad organizadora: BARCELONA, España
Martín, M. J.; Pardo, D.

85 Título del trabajo: Simulación microscópica de propiedades de transporte y ruido electrónico en dispositivos semiconductores
Nombre del congreso: Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE-97)
Ámbito geográfico: Nacional
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: BARCELONA, España
Fecha de celebración: 02/1997
Fecha de finalización: 28/02/1997
Ciudad entidad organizadora: BARCELONA, España
T. González; Velázquez, J. E.; Martín, M. J.; J. Mateos; Pardo, D.

86 Título del trabajo: Advances in noise modelling of high-field transport in semiconductor materials and devices
Nombre del congreso: Third ELEN Workshop
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Leuven, Bélgica
Fecha de celebración: 11/1996
Fecha de finalización: 30/11/1996
Ciudad entidad organizadora: Leuven, Bélgica
L. Reggiani; P. Golinelli; A. Greiner; C. Pennetta; V. Gruzinskis; E. Strikov; P. Shiktorov; L. Varani; J.P. Vaissiere; J.P. Nougier; Pardo, D.; T. González; Martín, M. J.; J.E. Velázquez.



- 87** **Título del trabajo:** Hydrodynamic modelling of transport and noise spectra in n+nn+ semiconductor structures
Nombre del congreso: 26th European Solid State Device Research Conference (ESSDERC'96)
Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Bolonia, Italia
Fecha de celebración: 09/1996
Fecha de finalización: 30/09/1996
Ciudad entidad organizadora: Bolonia, Italia
L. Reggiani; P. Shiktorov; V. Gruzinskis; E. Starikov; L. Varani; T. González; Martín, M. J.; Pardo, D.
- 88** **Título del trabajo:** Thermal conductivity of hot electrons in Si
Nombre del congreso: 23rd International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-23)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Berlín, Alemania
Fecha de celebración: 07/1996
Fecha de finalización: 31/07/1996
Ciudad entidad organizadora: Berlín, Alemania
P. Golinelli; R. Brunetti; L. Varani; L. Reggiani; E. Starikov; P. Shiktorov; V. Gruzinskis; T. González; Martín, M. J.; Pardo, D.

Otras actividades de divulgación

- 1** **Título del trabajo:** Realización WEB de exposición: <https://granrevoluciondelaelectronica.usal.es/>
Nombre del evento: La gran revolución de la Electrónica
Tipo de evento: Ferias y exhibiciones
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Salamanca,
Fecha de celebración: 09/11/2019
Entidad organizadora: Área de Electrónica. Universidad de Salamanca.
Ciudad entidad organizadora: Salamanca,
Martin M. J.. "<https://granrevoluciondelaelectronica.usal.es/>".
- 2** **Título del trabajo:** Comisaria de Exposición
Nombre del evento: 2ª Fase colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Tipo de evento: Ferias y exhibiciones
Ciudad de celebración: Salamanca,
Fecha de celebración: 01/10/2019
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Ciudad entidad organizadora: Salamanca,
Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.; Roco J. M..
- 3** **Título del trabajo:** Realización de cartelas de aparatos expuestos en las vitrinas : 2ª fase
Nombre del evento: 2ª Fase Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Tipo de evento: Ferias y exhibiciones
Ciudad de celebración: Salamanca,
Fecha de celebración: 01/10/2019
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Ciudad entidad organizadora: Salamanca,



Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.

4 Título del trabajo: Comisaria de Exposición

Nombre del evento: La gran revolución de la Electrónica

Tipo de evento: Ferias y exhibiciones

Ciudad de celebración: Salamanca,

Fecha de celebración: 09/11/2018

Entidad organizadora: Área de Electrónica. Universidad de Salamanca.

Ciudad entidad organizadora: Salamanca,

Martin M. J.; González, T.; Rengel, R.; Mateos, J.; Pascual, E.; Iñiguez de la Torre I; G. Vasallo, B..

5 Título del trabajo: Realización WEB de exposición: <http://museo.fis.usal.es/>

Nombre del evento: Colección de aparatos de Laboratorio de Física

Tipo de evento: Ferias y exhibiciones

Autor de correspondencia: Si

Ciudad de celebración: Salamanca,

Fecha de celebración: 09/11/2017

Entidad organizadora: Área de Electrónica. Universidad de Salamanca.

Ciudad entidad organizadora: Salamanca,

Martin M. J.. "<http://museo.fis.usal.es/>".

6 Título del trabajo: EDITOR del Journal of Physics: Conference Series

Nombre del evento: 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19)

Ámbito geográfico: Internacional no UE

Autor de correspondencia: Si

Fecha de celebración: 29/06/2015

González T.; Martin Martinez M. J.; Mateos J.. "19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON'19)". (Estados Unidos de América): ISSN 1742-6588

7 Título del trabajo: Realización de cartelas de aparatos expuestos en las vitrinas : 1ª fase

Nombre del evento: Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física

Tipo de evento: Ferias y exhibiciones

Ciudad de celebración: Salamanca,

Fecha de celebración: 01/09/2014

Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca

Ciudad entidad organizadora: Salamanca,

Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.

8 Título del trabajo: Realización de fichas de dos páginas

Nombre del evento: Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física

Tipo de evento: Ferias y exhibiciones

Ciudad de celebración: Salamanca,

Fecha de celebración: 01/09/2014

Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca

Ciudad entidad organizadora: Salamanca,

Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I.



- 9 Título del trabajo:** Comisaria de Exposición
Nombre del evento: Colección de aparatos de medida de los laboratorios de física
Tipo de evento: Ferias y exhibiciones
Ciudad de celebración: Salamanca,
Fecha de celebración: 01/02/2014
Entidad organizadora: Facultad de Ciencias. Universidad de Salamanca
Ciudad entidad organizadora: Salamanca,
Martin M. J.; Iñiguez de la Torre J. I; Roco J. M..

Gestión de I+D+i y participación en comités científicos

Comités científicos, técnicos y/o asesores

- 1 Título del comité:** Symposium: SBMicro 2016, Belo Horizonte. Brasil.
Entidad de afiliación: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais
Fecha de inicio: 04/2016
- 2 Título del comité:** Symposium: SBMicro 2015, Bahia. Brasil.
Entidad de afiliación: A Sociedade Brasileira de Microeletrônica
Fecha de inicio: 03/2015
- 3 Título del comité:** Symposium SBMicro 2014, Aracaju. Brasil.
Entidad de afiliación: UFS- Universidad Federal de Sergipe - A Sociedade Brasileira de Microeletrônica
Fecha de inicio: 03/2014
- 4 Título del comité:** Symposium: SBMicro 2013, Curitiba. Brasil.
Entidad de afiliación: UFPR-Universidade Federal do Paraná- A Sociedade Brasileira de Microeletrônica
Fecha de inicio: 03/2013
- 5 Título del comité:** Symposium: SBMicro 2012, Brasilia. Brasil.
Primaria (Cód. Unesco): 330700 - Tecnología electrónica
Entidad de afiliación: UnB -Universidade Brasilia. A Sociedade Brasileira de Microeletrônica
Ciudad entidad afiliación: Brasil
Fecha de inicio: 03/2012
- 6 Título del comité:** Symposium: SBMicro 2011, Sao Bernardo d. C. Brasil.
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Ciudad de radicación: Brasil
Entidad de afiliación: UFPB - Universidade Federal da Paraíba .A Sociedade Brasileira de Microeletrônica
Ciudad entidad afiliación: Brasil
Fecha de inicio: 30/08/2011

Organización de actividades de I+D+i

- 1** **Título de la actividad:** La Gran Revolución de la Electrónica
Tipo de actividad: Exposición científica **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Comisario/a de exposición
Fecha de inicio-fin: 09/11/2018 - 20/01/2019 **Duración:** 2 meses - 14 días
- 2** **Título de la actividad:** 12th Spanish Conference on Electron Devices (CDE 2018)
Tipo de actividad: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Organizador
Fecha de inicio-fin: 13/11/2018 - 16/11/2018 **Duración:** 4 días
- 3** **Título de la actividad:** Miembro del "Technical Committee" del congreso Trends in Nanotechnology (TNT 2003) Salamanca (España)
Tipo de actividad: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Fecha de inicio-fin: 15/09/2003 - 19/09/2003
- 4** **Título de la actividad:** Colección de aparatos de medida de los laboratorios de Física. Exp. Permanente.
Tipo de actividad: Exposición científica **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Comisario/a de exposición
Fecha de inicio: 01/02/2016
- 5** **Título de la actividad:** 19th International Conference on Electron Dynamics in Semiconductors, Optoelectronics and Nanostructures (EDISON19)
Tipo de actividad: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Organizador
Fecha de inicio: 29/06/2015 **Duración:** 5 días
- 6** **Título de la actividad:** 18th International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF2005)
Tipo de actividad: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Organizador
Fecha de inicio: 19/09/2005
- 7** **Título de la actividad:** Trends in Nanotechnology (TNT 2003)
Tipo de actividad: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional no UE
Modo de participación: Organizador
Fecha de inicio: 15/09/2003

Gestión de I+D+i

- 1** **Nombre de la actividad:** Gestión: Modelado y optimización de arquitecturas MOSFET avanzadas para aplicaciones analógicas de alto rendimiento (SA188A11)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por la JCyL. IP
Fecha de inicio: 2011



- 2** **Nombre de la actividad:** Gestión: Investigación de transistores MOSFET nanométricos no convencionales: modelado del ruido electrónico y caracterización a alta frecuencia (TEC2009-07597)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. IP
Fecha de inicio: 2010
- 3** **Nombre de la actividad:** Gestión: Investigación Monte Carlo de dispositivos MOSFET nanométricos no convencionales para aplicaciones de radiofrecuencia (TEC2008-02266)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. IP
Fecha de inicio: 2009
- 4** **Nombre de la actividad:** Gestión: Dispositivos MOSFET de Silicio no convencionales: Investigación Monte Carlo de los mecanismos de transporte de carga en transistores ultra-escalados para aplicaciones de alta frecuencia (SA010A07)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por la JCyL. IP
Fecha de inicio: 2007
- 5** **Nombre de la actividad:** Gestión: Análisis Monte Carlo del comportamiento a alta frecuencia de dispositivos MOSFET bulk y SOI avanzados (SA008B05)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por la JCyL. IP
Fecha de inicio: 2005
- 6** **Nombre de la actividad:** Gestión: Thematic network on Silicon on Insulator technology, devices and circuits: EUROSOI (IST-1-506653-CA)
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por la Comisión Europea. IP local.
Fecha de inicio: 2004
- 7** **Nombre de la actividad:** Gestión: SIGMA. SiGe for mobile Communication Applications. Project 01 M 2975
Tipología de la gestión: Gestión de acciones y proyectos de I+D+i
Funciones desempeñadas: Proyecto de Investigación financiado por la Unión Europea. IP local
Entidad de realización: TU Delft. The Netherlands
Fecha de inicio: 1997 **Duración:** 2 años - 7 meses

Evaluación y revisión de proyectos y artículos de I+D+i

- 1** **Nombre de la actividad:** Subcomisión TEC-MIC (Dispositivos Electrónicos y Fotónicos)
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de la Subdirección General de Proyectos de Investigación (SGPI). Proyectos del Plan Estatal I+D+i Retos y Excelencia. 2017.
Fecha de inicio-fin: 2017 - 11/11/2017
- 2** **Nombre de la actividad:** Área IEL-Ingeniería Eléctrica, Electrónica ,Automática/Electric Eng.Automatic.Control:
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Fecha de inicio: 2018



- 3** **Nombre de la actividad:** Área IEL-Ingeniería Eléctrica, Electrónica ,Automática/Electric Eng. Automatic Control:
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Fecha de inicio: 2016
- 4** **Nombre de la actividad:** Área COM - Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones/Electronics and Comm. Tech.:
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Fecha de inicio: 2015
- 5** **Nombre de la actividad:** Área IND - Transferencia de Tecnología/Technology Transfer
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Fecha de inicio: 2015
- 6** **Nombre de la actividad:** Área TM - Ciencia y Tecnología de Materiales
Funciones desempeñadas: Experto evaluador de La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP)
Fecha de inicio: 2014
- 7** **Funciones desempeñadas:** Revisor en Journal of Computational Electronics
- 8** **Funciones desempeñadas:** Revisor en Semiconductor Science and Technology
- 9** **Funciones desempeñadas:** Revisor en IEEE Transactions on Electron Devices
- 10** **Funciones desempeñadas:** Revisor en Journal of Applied Physics
- 11** **Funciones desempeñadas:** Revisor en Nanotechnology

Otros méritos

Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

- 1 Entidad de realización:** DIMES (Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology)
Ciudad entidad realización: DIMES (Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology), Holanda
Fecha de inicio-fin: 09/01/1999 - 29/04/1999 **Duración:** 2 meses
Objetivos de la estancia: Posdoctoral
Tareas contrastables: Caracterización dc y microondas de amplificadores, filtros y estructuras de test fabricados en TEMIC. Realización de "layouts" de diferentes estructuras activas y filtros integrados para aplicaciones DECT y GSM. Caracterización RF
- 2 Entidad de realización:** DIMES (Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology)
Ciudad entidad realización: DIMES (Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology), Holanda
Fecha de inicio-fin: 06/02/1998 - 04/08/1998 **Duración:** 2 meses - 19 días
Objetivos de la estancia: Posdoctoral
Tareas contrastables: Diseño y modelado de circuitos integrados monolíticos con tecnología Bipolar de SiGe. Realización de "Layouts" y caracterización dc y microondas de dispositivos pasivos y circuitos activos.
- 3 Entidad de realización:** DIMES, Technical University of Delft
Ciudad entidad realización: DIMES, Technical University of Delft, Holanda
Fecha de inicio-fin: 01/01/1997 - 31/12/1997 **Duración:** 1 año
Entidad financiadora: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC)
Objetivos de la estancia: Posdoctoral
Tareas contrastables: Programa Nacional de Becas de Formacion de Personal Investigador en el Extranjero. Subprograma de Perfeccionamiento para Doctores y Tecnólogos en el Extranjero
Resultados relevantes: Modelización y simulación electrónica de dispositivos y circuitos integrados con tecnología bipolar Si/SiGe para aplicaciones GSM
- 4 Entidad de realización:** NORTEL (Northern Semiconductors)
Ciudad entidad realización: NORTEL (Northern Semiconductors), Reino Unido
Fecha de inicio-fin: 21/07/1997 - 09/08/1997 **Duración:** 15 días
Objetivos de la estancia: Posdoctoral
Tareas contrastables: Simulador CADENCE. Conceptos de diseño de circuitos y schematics. Elementos parásitos y dependencias de un diseño analógico RF. Efectos en el rendimiento del circuito
- 5 Entidad de realización:** TEMIC Semiconductors **Tipo de entidad:** Entidad Empresarial
Ciudad entidad realización: Heilbrom, Alemania
Fecha de inicio-fin: 01/06/1997 - 13/06/1997 **Duración:** 15 días
Objetivos de la estancia: Posdoctoral
Tareas contrastables: Estudio de la tecnología de SiGe de Temic, ventajas sobre tecnología de Si. Componentes y librerías de diseño. Diseño de sistemas Si-Ge "on-chip" para sistemas de comunicaciones y redes móviles de alto rendimiento. Productos de RF y microondas.
- 6 Entidad de realización:** Departamento de Física y Astronomía de la FCUP
Ciudad entidad realización: Porto, Portugal
Fecha de inicio: 19/03/2016



Objetivos de la estancia: Posdoctoral

Tareas contrastables: Caracterización experimental de los procesos involucrados en la dinámica de portadores fotoexcitados en Grafeno mediante espectroscopía resuelta en el tiempo. Medidas de transmisión de la señal a través de las muestras de grafeno mediante un montaje pump-probe

7 Entidad de realización: CMO (Composants pour la Microélectronique et l'Optoélectronique).

Facultad, instituto, centro: Institut d'Electronique Fondamentale, Université Paris-Sud.

Ciudad entidad realización: Orsay, Francia

Fecha de inicio: 20/09/1999

Duración: 20 días

Objetivos de la estancia: Posdoctoral

Tareas contrastables: Simulación Monte Carlo de dispositivos MOSFET.

Ayudas y becas obtenidas

1 Nombre de la ayuda: Programa Nacional de Becas de Formación del Personal Investigador en el Extranjero

Finalidad: Posdoctoral

Entidad concesionaria: Subprograma de Perfeccionamiento para Doctores y Tecnólogos en el Extranjero. (M.E.C.).

Fecha de concesión: 01/01/1998

Duración: 1 año

Fecha de finalización: 31/12/1998

Entidad de realización: TU Delft. Universidad Tecnológica de Delft. Países Bajos

2 Nombre de la ayuda: Programa Nacional de Becas de Formación del Personal Investigador en el Extranjero

Finalidad: Posdoctoral

Entidad concesionaria: Subprograma de Perfeccionamiento para Doctores y Tecnólogos en el Extranjero. (M.E.C.).

Fecha de concesión: 01/01/1997

Duración: 1 año

Fecha de finalización: 31/12/1997

Entidad de realización: TU Delft. Universidad Tecnológica de Delft. Países Bajos

3 Nombre de la ayuda: Becario de Investigación FPI. (Área: Electrónica. Dpto. Física Aplicada)

Finalidad: Predoctoral

Entidad concesionaria: Universidad de Salamanca **Tipo de entidad:** Universidad

Fecha de concesión: 01/01/1993

Duración: 3 años

Fecha de finalización: 31/12/1995

Entidad de realización: Universidad de Salamanca

Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias

Premios, menciones y distinciones

Descripción: Premio extraordinario de Licenciatura curso 1991-1992.

Entidad concesionaria: Universidad de Salamanca



Períodos de actividad investigadora

Nº de tramos reconocidos: 4

Entidad acreditante: Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

Fecha de obtención: 31/12/2017

Acreditaciones/reconocimientos obtenidos

Descripción: Acreditación para el cuerpo de Catedrático de Universidad: Ingeniería y Arquitectura.

Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Tipo de entidad: .

Fecha del reconocimiento: 11/01/2012